博士論文

2-アミノエタンチオールおよびヒドロキノンの

多結晶金電極への吸着特性と

吸着の電気化学特性への影響

Adsorption Characteristics of 2-Aminoethanethiol and Hydroquinone onto Polycrystalline Gold Electrodes and Effect of the Adsorption on Electrochemical Properties

指導教官

高田 主岳教授

2019年

名古屋工業大学大学院 工学研究科 生命 応用化学専攻

内藤 久実

博士論文目次

第1章	序論⋯	1
1.1	はじめ	9に2
1.2	吸着現	見象
	1.2.1	吸着現象
	1.2.2	吸着相互作用4
	1.2.3	吸着平衡
	1.2.4	吸着速度
1.3	アルキ	-ルチオールの自己組織化単分子膜
	1.3.1	分子機能電極
	1.3.2	自己組織化単分子膜
	1.3.3	自己組織化単分子膜の評価方法
	1.3.4	自己組織化単分子膜の利用
	1.3.5	アミノエタンチオール
1.4	キノン	類
	1.4.1	キノン類
	1.4.2	キノン類の電気化学
	1.4.3	キノン類の電極表面への吸着
1.5	本研究	℃の目的と意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2.1	緒言·		26
2.2	実験·		27
	2.2.1	試薬および装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
	2.2.2	金電極の洗浄	27
	2.2.3	アミノエタンチオールの金電極への吸着	27
	2.2.4	還元脱離法による吸着したアミノエタンチオールの定量	27
	2.2.5	単結晶金(111)電極の作製および電気化学測定	29
	2.2.6	パルス磁場勾配核磁気共鳴測定による拡散係数の測定	31
2.3	結果と	:考察	32
	2.3.1	電極表面積の定量および結晶面の同定	32
	2.3.2	アミノエタンチオールの還元脱離電位	34

	2.3.3	吸着	の熱力学・速度論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
	2.3.4	吸着	特性評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
	2.3	.4.1	速度論的評価	41
	2.3	.4.2	熱力学的評価	48
2.4	結言…			50

第3章	ヒドロニ	キノンの多結晶金電極への吸着特性評価	51
3.1	緒言·	5	52
3.2	実験		53
	3.2.1	試薬および装置	53
	3.2.2	ヒドロキノンの金電極への吸着	53
	3.2.3	電気化学測定および吸着したヒドロキノンの定量	53
	3.2.4	飛行時間型二次イオン質量分析測定	54
3.3	結果と	:考察	55
	3.3.1	ベンゾキノン/ヒドロキノンの電極反応	55
	3.3	.1.1 ヒドロキノン水溶液中における電極反応	55
	3.3	.1.2 ベンゾキノン水溶液中における電極反応	59
	3.3.2	ヒドロキノンの多結晶金電極への吸着特性評価	30
	3.3	.2.1 pH 未調整 ···································	30
		3.3.2.1.1 速度論的評価	30
		3.3.2.1.2 熱力学的評価	34
		3.3.2.1.3 脱離条件	37
	3.3	.2.2 pH の影響 ······ 7	74
	3.3.3	ベンゾキノンの多結晶金電極への吸着特性評価	78
	3.3.4	飛行時間型二次イオン質量分析法による金電極への吸着の直接評価8	30
	3.3	.4.1 ヒドロキノン	30
	3.3	.4.2 ベンゾキノン	31
3.4	結言·		32

第4章 金電極へ吸着したヒドロキノンの溶存種の電気化学特性への影響……83

4.1	緒言·		84
4.2	実験·		85
	4.2.1	試薬および装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85

4.2.2	ヒドロキノン吸着電極の作製	· 85
4.2.3	電気化学測定	· 85
4.3 結果と	と考察	· 86
4.3.1	ベンゾキノン/ヒドロキノンに対する応答	· 86
4.3.2	外圏型電子移動を伴う酸化還元活性種に対する応答	· 91
4.3.3	内圏型電子移動を伴う酸化還元活性種に対する応答	· 94
4.4 結言		· 97

第5章	結論	
参考文	て献	 102
発表論	文	 106
発表状	≿況	 107
受賞·		 110
謝辞·		

第1章 序論

1.1 はじめに

電極の分子修飾は、電極特性の改変や新たな機能の発現が行えることから1980年代か ら精力的に研究が行われ¹、今日では常套手段となっている。分子修飾法の代表的なもの に、アルキルチオールなどの自己組織化による修飾法がある。この方法は容易に電極表 面へ高密度な単分子膜が作成できることから特によく使われる。その中でも、2-アミノエ タンチオール(AET)は炭素鎖が2と短いことから、酸化還元活性種と電極との電子移動を 妨げにくく、また末端に反応性の高いアミノ基を有していることから、電極に機能性分 子を導入するためのアンカーとしてよく用いられている²⁻⁶。しかし、配向性が低いため、 その後導入される分子の配向性も必然的に低くなるという問題を抱えている。また、自 己組織化膜を電極触媒反応やセンシングなど実際に応用する際には、準備が容易であり、凹 凸が大きい方が修飾分子を物理的に固定しやすいことから、多結晶金電極がよく用いられる。 しかし、AETの多結晶金電極への吸着に関する詳細な報告はない。そこで、本研究ではAET の多結晶金電極への吸着特性の詳細な評価を行った。

アルキルチオールはチオール基を有し、チオールと金との高い結合力のため化学吸着 するが、チオール基のような吸着基を持たない分子も電極に吸着する。これらも分子機能 電極として働く。本研究では、ヒドロキノン(QH₂)が多結晶金電極に吸着し、さらに吸着し たQH₂が溶存種の電子移動速度に影響を与えることを見出した。QH₂と金電極とでは相互 作用が起こりにくいと考えられるため、QH₂の吸着は非常に興味深く、その評価は重要で ある。このメカニズムを解明できれば、他の小分子吸着のモデルと成り得、触媒やセン サ等への応用の基礎的な知見となると考えられる。また、溶存種の電気化学特性への影 響では、一般的には同じ化学種の吸着によりその電子移動が速くなることが報告されて いるが、自種の電子移動を妨害する現象は新しい。吸着したQH₂が全体の酸化還元反応に 影響を与えている可能性が高いことから、QH₂の吸着により溶存種の電子移動を制御でき る可能性があり、センサ等への応用も期待される。

2

1.2 吸着現象

1.2.1 吸着現象

吸着とは、気相/固相または液相/固相中の物質が、その相と接触する他の相との界面に おいて、相の物質の密度、またはその相内に溶解している溶質の濃度が、バルク相と界 面で違う場合をいう。吸着される物質を吸着質、他の物質を強く正吸着する物質を吸着 剤という。吸着特性評価には、物質量論、エネルギー論、構造論などがあるが、量論が 吸着の基礎理論となっている⁷。

吸着量は、液相の場合には溶質の濃度、気相の場合には圧力および温度に依存し、そ れらの量的関係は吸着剤の基本的な性質を示す。温度一定下における吸着量と濃度(液相) または圧力(気相)との関係を吸着等温線という。1.2.3節で詳述するように、吸着等温線は 吸着質と吸着剤との組み合わせによって様々な形の曲線となり、その形は吸着質と吸着 剤の物理的相互作用を反映する。吸着質が界面から離れ、吸着量が減少する現象を脱離 という。界面において吸着質分子やイオンは吸脱着を繰り返しているので、吸着する量 と脱離する量が変化しない状態を吸着平衡という。なお、気相/固相吸着では、吸着剤/吸 着質間だけの相互作用であるが、液相吸着では溶液内の溶媒分子/吸着質分子間相互作用 および溶媒分子/吸着剤界面の相互作用(あるいは溶媒と溶質の競争吸着)も関係する。 1.2.2 吸着相互作用

吸着現象は、吸着剤と吸着質間のエネルギー相互作用である。吸着剤表面と吸着質分 子には多数の種類があり、吸着相互作用は二者の組み合せによって決まる^{7,8}。以下に主な 相互作用について述べる。

(1)電荷移動相互作用

(1-1)水素結合

固体表面にはヒドロキシ基、チオール基、カルボキシ基、スルホン酸基、アミノ基な どの水素原子を有する極性官能基が存在する場合が多い。これらの表面官能基の水素原 子は、吸着分子の電気陰性度の大きい原子の非結合電子対と直線的なの結合型の水素結合 を形成する、また表面官能基の水素に結合している原子が非共有電子対を持つ場合には、 吸着分子の水素原子と先と同様な水素結合を作る。水素結合は後に述べる静電引力とは 異なる。また結合の強さはファンデルワールス力のおよそ5-10倍である。

(1-2)酸、塩基

吸着剤の主成分の原子種に比べて、原子価または電気陰性度の異なる不純物原子が表 面に存在すると、不純物原子が主成分原子に比べて電子過剰であれば電子供与性サイト、 あるいは不純物原子が電子不足であれば電子受容性サイトとなる。このように、表面上 の電子供与あるいは受容性サイトは、電子受容性あるいは供与性をもつ分子と互いに軌 道を形成し、電荷移動錯体を形成する。

(1-3) π軌道相互作用

不飽和炭素結合のπ軌道の負の電荷分布は表面の電子供与、あるいは受容サイトと電荷 移動により吸着する。例えば、ニトロベンゼンは、炭素原子に電子吸引性の大きいニト ロ基を有しているため、このπ軌道は電荷不足になり、電子受容性をもつ。 (2)静電引力(斥力)

固体表面に正または負の電荷を持つ場合、イオンの吸着や交換サイトになる。例えば、 表面に酸性または塩基性サイトの官能基が存在する場合には、水溶液中における固体表 面は、

$$-NH_2 + H_2 O = -NH_3^+ + OH^-$$
(1-1)

$$-0H + H_3 0^+ = -0H_2^+ + H_2 0$$
(1-2)

$$-0H + H_2 0 = -0^- + H_3 0^+$$
(1-3)

4

のように正または負に帯電する。

(3) 疎水性相互作用

疎水性相互作用は、特に極性溶媒である水からの吸着のときにのみ現れる作用である⁸。 水は水素結合によりある程度の構造体を形成し、それが揺らいでいる。疎水性の分子が 水に溶けている場合、この構造が崩壊され、それによって水分子同士の結合が、他のも のに比べて大きいと吸着が起こる。吸着剤表面が疎水性であれば、静電引力などが働か ない場合においても、吸着剤と吸着質との間には強い相互作用が働く。

(4)ファンデルワールスカ

ファンデルワールスカとは、電気四重極子相互作用および電気双極子相互作用、London 分散力の総称である。これらの弱い分子間によって起こる吸着を物理吸着と呼ぶ。

(4-1)電気四重極子相互作用

表面の隣り合った原子のグループ間に4極の電荷分布の片寄りが存在した場合、電気四 重極子を持つ。これと同様な電気四重極子モーメントをもつ吸着質分子と、表面電気四 重極子サイトとが相互作用する。

(4-2) 電気双極子相互作用

表面で電気陰性度の異なる原子が化学結合しているとき、電子分布が片寄り、結合モ ーメントが現れる。これが双極性吸着質分子と相互作用する。

(4-3) London分散力

固体表面にある原子と吸着質分子、あるいは吸着質分子同士が互いに接近すると、吸 着質分子および固体表面の原子の原子核と周囲の軌道電子の相対的振動の揺らぎにより 瞬間的に電気的な分極が起こる。それが相対する原子を分極させ、弱い電気相互作用引 力が発生する。 1.2.3 吸着平衡

吸着が平衡状態であるとき、吸着の量論を表す最も一般的な方法は吸着等温線である。 吸着質と吸着剤との組み合わせによって様々な形の曲線となり、その形は吸着質と吸着 剤との物理的相互作用をよく表す。本節では、液相吸着における吸着等温線について詳 述する。

ーつの成分の濃度が他の成分に比べてかなり低い溶液からの吸着の場合における吸着 等温線の形は、最初の低濃度の傾斜について4つの型に分けられる⁹。Figure 1-1に示すよ うに、4つの主クラスはS (S字型)、L (Langmuir)、H (high affinity)、C (constant partition) 型である。各クラスは曲線の上部の形によりさらにサブグループに分けられる。

(1) S型

吸着曲線の低濃度領域では、吸着量が増加するほど、吸着物質はさらに吸着され易く なっている。このことは、吸着質分子同士が吸着剤表面で会合していることを意味して おり、これを協同吸着という。このS字型は、吸着質分子内に官能基を一つしか持たない、 中程度の分子間力を有し吸着層に垂直に配向して密に吸着できる、溶媒分子が吸着剤の 吸着サイトを強く奪い合う場合を示している。

(2) L型

Langmuirがこの等温線を詳細に解析したことから、Langmuir型と呼ばれている。この 型は表面の吸着サイトが被覆されるにつれて、衝突する吸着分子が空のサイトを見出す 確率が低くなることを示している。また、固体表面における吸着サイトの反応活性度が 高く、単分子層吸着エネルギーが大きい。そのため吸着が非可逆の場合が多く、化学吸 着とも言われる。なお、Langmuir吸着等温式は、吸着した分子間の相互作用が小さい場 合に適応できる。吸着質間の相互作用が存在する場合は、Langmuir吸着等温式を拡張し たFrumkin吸着等温式が適応できる(2.3.3節)。Langmuir吸着等温式は、統計熱力学、熱力 学、質量作用の法則、絶対反応速度などを用いて導出することができる。熱力学および 速度論を用いた導出方法は2.3.3節で詳述する。

(3) H型

H型はL型曲線の特別な場合である。吸着質の吸着剤への親和性が非常に高いので、ご く低濃度でも吸着質はほとんど吸着されるため、吸着等温線の初期部分はほとんど垂直 に近い。

(4) C型

C型はHenry式(Eq. 1-4) で表される低濃度における吸着と分配を表している。一次的な

$$W = K_{\rm P}C \tag{1-4}$$

W:吸着剤単位重量当たりの吸着量、K_P:吸着定数、C:溶質の平衡濃度

関係であることから吸着サイト数は一定で変化しない、すなわち、吸着質が吸着し、吸 着剤の吸着サイトが占有されると、新たに同数のサイトが作り出されることを表してい る。



Equilibrium concentration

Figure 1-1 Classification of isotherms in case of adsorption from dilute concentration of adsorbate in solution.

1.2.4 吸着速度

1.2.3節で述べた吸着平衡は、すべて平衡論的な見方によるものであり、静的吸着と呼ばれている。したがって、特定の条件における平衡吸着量を求めることは吸着特性を理解する上で重要である。しかし、吸着過程は常に平衡に到達しているわけではなく、むしろ吸着過程は速度論によって支配される。平衡吸着量を得るためにどれだけの時間を必要とするかといった動的吸着、すなわち吸着の速度論を評価することは、実際の系の場合では特に重要である。

吸着速度v_fと脱離速度v_bは、吸着量の時間微分である。吸着量の変化から全体の反応速 度vは

$$v = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = v_{\mathrm{f}} - v_{\mathrm{b}} \tag{1-5}$$

 θ. 表面被覆率(吸着量を飽和吸着量で規格化したもの)、t. 時間 が導かれる。速度については何種類もの定式化が行われているが¹⁰、平坦な固体表面上で 吸着単分子層が完成したところで、吸着速度が0となるとするLangmuirの速度論がもっと も重要である²。この速度論については2.3.3節で詳述する。 1.3 アルキルチオールの自己組織化単分子膜

1.3.1 分子機能電極

機能性分子を合目的に電極表面へ導入した電極を「分子機能電極」と呼ぶ¹¹。電極の分 子修飾の概念は、1973年のLaneら¹²、1975年のMillerら¹³の報告が発端となる。その後、 電極特性の改変や新たな機能の発現が行えることから、1980年代から精力的に研究が行 われ¹、今日ではセンサ、触媒材料、エネルギー変換材料、分子素子等への様々な応用が 展開されている²。修飾電極は導入した機能性分子の修飾した膜の厚さにより、主に高分 子膜修飾電極と単分子膜修飾電極に分類される²。

高分子膜修飾電極では主に以下の4つの場合に電極活性が発現する。(1)高分子鎖に存在 する電荷と反対の電荷を持つ金属錯体や電極活性な分子が、主に静電的相互作用により 高分子電解質の膜内に固定される場合、(2)高分子の側鎖に金属錯体やビオロゲン分子な どの電極活性な有機分子が共有結合で固定される場合、(3)高分子の側鎖にある配位子に より、膜内へ金属錯体が形成される場合、(4)高分子自身が電子伝導性を示す場合などが ある¹⁴。

近年では、ナノオーダーでの修飾がなされる単分子膜修飾電極の研究が盛んに行われ ている。単分子膜修飾電極の中でも自己組織化単分子膜(SAM)は、自発的に電極表面へ高 密度に修飾された膜であることから、電極表面をナノスケールで思い通りにデザインす ることができる。そのため、電極の特性と分子の特性との相関性の評価はもちろんのこ と、分子配列への依存性を評価し、機能性を向上させる研究も活発に行われている。

1.3.2 自己組織化単分子膜

電極の分子修飾法の代表的なものに、アルキルチオールなどの自己組織化による方法がある。アルキルチオール(CH₃(CH₂)_nSH)、あるいはアルキルジスルフィド(CH₃(CH₂)_nS–S(CH₂)_nCH₃)の溶液に、金、白金、銀、銅などの金属を浸漬させると、表面にチオラートとして化学吸着し(Eq. 1-6)、分子が規則正しく並んだSAMが容易に形成される¹⁵。

$$M + H - SR \rightleftharpoons M - SR + H^+ + e^-$$
(1-6)

アルキルチオールの固体表面への吸着過程をFig. 1-2に示す。吸着の初期では、吸着した分 子の密度は低く、head group (チオール)が化学吸着するとともにアルキル鎖も固体表面に物 理吸着するため、分子は固体表面に寝た状態となる(Fig. 1-2A)¹⁶。この吸着の初期段階は、拡 散律速Langmuir吸着モデルによってよく表される^{17,18}。一方、分子の吸着が十分に進むと、吸 着分子間の距離がアルキル鎖長よりも短くなり、吸着分子が傾くことによりアルキル鎖同士が 接近する。アルキル鎖同士が十分接近すると、ファンデルワールスカが働き、最も安定なエネ ルギー状態となる間隔で固定される(Fig. 1-2B)。すなわち、分子が固体表面に高密度に吸着し、 個々の分子が傾いて自ら最も安定な状態となる。この第二段階は、表面の結晶化過程と呼ば れており、配向性の低いアルキルチオールは二次元の結晶を形成する^{17,18}。

金は面心立方構造を持つ。金(111)面は六方最密構造で並んでおり、熱力学的に最も安定な 面である。また金(111)面はファセットとして現れ易いことから¹⁹、SAMの下地として最もよく用い られている²⁰。金(111)面に吸着した長鎖アルキルチオール分子は、金原子の1/3の密度で金 原子のホローサイトに吸着し、隣り合ったチオール分子間の最短距離は金原子間のそれの $\sqrt{3}$ 倍になる(Fig. 1-3A)。またチオール分子の並んだ軸方向は金(111)面の原子のそれに対して 30°傾いている(Fig. 1-3B)。このような状態で吸着したアルキルチオールの配列構造は、金 (111)面の構造に対して相対的な関係として示され、($\sqrt{3} \times \sqrt{3}$) R30°構造と表記される。SAMを 形成したアルキルチオールの配列は、走査トンネル顕微鏡(STM)、電子線回折法や中性子回 折法などによって確認されている¹⁵。その配列や吸着の速度論は、金の結晶面、アルキルチオ ールのアルキル鎖長や官能基の種類によって異なることが報告されている^{18,20-27}。

アルキル鎖のω末端にある官能基がsurface groupとして置換されていると、それが高密度に 存在する表面が作られる。したがって、官能基を有するアルキルチオールのSAMを形成すると、 金属表面の性質を変えたり、金属表面に機能性を付与することができる^{6,15,28}。例えば、トリフ ルオロメチル基やメチル基を有するチオール単分子表面は高い疎水性を有する。一方、ヒドロ キシ基やカルボキシ基などの親水性の官能基を有するチオールは、単分子表面に親水基が高 密度に存在する。このようにSAMは吸着分子が高密度に存在するため、1層の単分子でありな がら金属表面の特性を容易に変えることができる。さらに、フェロセン基やキノンなどの電気化 学的活性な官能基を有するチオールを用いると、それらの活性を電極表面に付与することがで きる。また、他の物質と容易に結合する置換基を有するチオールのSAMを用いた場合、単分子 膜上にさらに機能性分子を修飾させることが可能となる。このような単分子膜の利用法につい ては1.3.4節で紹介する。



Figure 1-2 Schematic illustration of adsorbed alkylthiol molecules at (A) low density and (B) high density forming SAM.



В



Figure 1-3 Schematic illustration of adsorbed long-chain alkylthiols on Au(111) with $(\sqrt{3} \times \sqrt{3}) R30^{\circ}$ structure. (A) Top view and (B) side view.

12

А

1.3.3 自己組織化単分子膜の評価方法

アルキルチオールのSAMの特性評価にはSTM^{15,29}、原子間力顕微鏡^{17,30}、電子線回折法¹⁵、 中性子回折法¹⁵、X線回折法^{21,31}、赤外反射吸収分光法¹⁵、接触角¹⁸、X線光電子分光法¹⁸、サ イクリックボルタンメトリ(CV)^{20,22-25}など、様々な手法が用いられている。本節では、本論文で用 いるCVによるアルキルチオールのSAMの還元脱離について述べる。

電極表面に形成されたアルキルチオールのSAMを還元することにより、電極表面から還元 的に脱離させる方法がよく用いられる^{20,22-25}。SAMで修飾された電極をアルカリ性水溶液に浸 して負の電位を加えると、Eq. 1-7の還元反応が進行し、吸着していたチオール分子は脱離す

$$M - SR + e^{-} \rightarrow M + RS^{-}$$
(1-7)

M: 金属, -SR: アルキルチオール

る。CVにより電位を負側に掃引すると、この還元脱離に伴って鋭い還元ピークが出現する。この還元ピークの電気量から、SAMの表面濃度*I*を算出することができる。またピーク電位や半値幅から、SAMの安定性や配向性などの吸着状態を評価することも可能である。

自己組織化法によって作成された単分子膜は、バリアフィルム、化学およびバイオセンサ、ド ラッグデリバリー、バイオ燃料電池など、様々な用途に応用されている^{6,17,28,32,33}。以下に具体 的な利用例を示す。

金電極表面に長鎖アルキルチオールのSAMを形成させると、電極は電気化学的に不活性に なる。未修飾の金電極およびヘキサデカンチオールのSAMで修飾した電極を用いて、フェリ/フ ェロシアン化物イオンのCVを行うと、未修飾の金電極では、フェリ/フェロシアン化物イオンの酸 化還元ピークが出現するのに対し、ヘキサデカンチオール修飾電極では出現しない³⁴。これは、 ヘキサデカンチオールを修飾したことにより、電極表面で電気化学反応が起きていないことを 示している。1.3.2で述べたように、アルキルチオール同士はファンデルワールスカによって高 密度にパッキングされた状態であるため、単分子でありながら長鎖アルキルオールはブロッキ ング効果を示す。一方、炭素数が2~4のように短いアルキル鎖の場合には電極表面と溶液と の間にトンネル電流が流れるため、ブロッキング効果は弱い²⁸。

金表面にフェロセン基を末端に有するアルキルチオールのSAMを修飾した電極が報告され ている^{16,35}。この電極を用いてCVを行うと、酸化還元ピークが出現し、電極表面にフェロセンが 固定化されたことが示された。このような電気化学的活性種の電極表面への固定には、他にも 活性種が置換された高分子を電極表面にキャストするなどの方法がある。しかし、高分子を用 いた場合、個々の活性種は様々な方向を向いており、また電極表面からの距離も一定でない。 一方、SAMを用いた場合、活性種の電極表面からの距離、方向性、および活性種の密度は均 ーとなるため、単一な状態の活性種の電気化学的特性評価が可能となる。

上記のフェロセン修飾電極は、あらかじめ酸化還元活性種が置換したチオールを合成し、そ れを用いて電極表面にSAMを形成させているが、他の分子と共有結合を形成することのできる 官能基を有するチオールのSAMを修飾し、それと機能性分子を結合させる手法も用いられて いる。広く用いられているのが、コハク酸イミジル基が置換したカンボン酸基を末端に有するチ オールである^{36,37}。コハク酸イミジル基は、アミノ基を有する分子が存在すると容易に置換され てアミド結合が形成される。例えば、アミノ基を有するキノン誘導体やフェロセン誘導体を用いる ことによって、電極にそれぞれの酸化還元活性種を固定できる。また、酵素やタンパク質で構 成されている多くの生体分子はアミノ基を有するリシンを含むので、それを介して電極表面に固 定できる。この手法を用いてグルコースオキシダーゼや乳酸化酵素を固定した電極を用いた酵 素センサが開発されている。例えば、カルボン酸末端を持つSAMを修飾した後、1-エチル -3-(3-ジメチルアミノプロピル)-カルボジイミド塩酸塩(EDC)とN-ヒドロキシコハク酸イミドを用い て、カルボン酸を活性エステルとした後、タンパク質のアミノ基とアミド結合で固定化する方法が ある³⁸。

前述したように炭素鎖が15以上の長鎖アルキルチオールのSAMは、固体の結晶と同程度の パッキング状態となり、安定な状態になっていることから、機能性単分子膜を得る目的でよく用 いられている。一方、電極との電子移動の観点からは、炭素鎖が長くなればなるほど不利にな る。そのため、吸着密度やチオール分子の配向性は低くなるが、鎖長が短いアルキルチオー ルも多く用いられている。末端に反応性の高いアミノ基を有するAETは、その目的で最も広く用 いられている。AETについては次節で詳しく述べる。 1.3.5 アミノエタンチオール

本節では、末端に反応性の高いアミノ基を有したAETについて概説する。AETのSAMは、末端にアミノ基を持つ短鎖アルキルチオール単分子膜として、電極表面の電荷や疎水性の制御³、 また高分子や酵素、タンパク質等の生体分子を固定化するアンカー層としても利用されている ^{4-6,28,39}。

AETのpKは25 °Cにおいて8.21であるが⁴⁰、金電極に修飾したSAMでは5.3と低くなることが 報告されている⁴¹。これは、SAMではアミノ基同士が溶液中と比較して接近しているため静電 的反発が大きく、プロトン化しにくいためである。

金電極に修飾されたAETがアスコルビン酸の電気化学的酸化に及ぼす影響が報告されてい る³。そこでは、AETの他に官能基としてメチル基、ヒドロキシ基、スルホ基を有するエタンチオ ールを用い、アスコルビン酸の酸化をリニアスイープボルタンメトリによって評価している。未修 飾の金電極や他の官能基を有するエタンチオールと比較して、AETではアスコルビン酸の酸化 電位が約0.08 V負側にシフトした。これは、AETを修飾したことにより、未修飾の金電極と比較 して電極表面の親水性が高くなり、また正に荷電するため、負に荷電したアスコルビン酸との親 和性が向上するためである。そのため、アスコルビン酸を燃料とする電池を構成する上で、電 極にAETを修飾すると、電池の開放電圧は高くなることが期待されている。

また、金電極とポリアクリル酸ゲルとのアンカーとしてAETを用いた電気化学アクチュエータ が報告されている^{4,5}。金電極にAETを導入し、アミド結合生成の触媒であるEDCを含むアクリ ル酸水溶液に電極を浸漬し、チオールとアクリル酸とを結合させている。この処理により金薄膜 表面にビニル基が導入され、ゲルを重合する際に、ゲルと金薄膜との間にも化学結合が形成さ れる。この化学結合により、金電極とポリアクリル酸ゲルが剥離しにくくなり、アクチュエータの 動作特性が向上した。

生体分子固定のアンカーとして、金電極へのDNAの修飾が報告されている⁶。そこでは、 AETを金電極に修飾させ、EDCを含むオリゴヌクレオチドの溶液に浸漬させることにより、金電極とオリゴヌクレオチドとを共有結合させ、DNAバイオセンサとしている。この共有結合により、DNAハイブリゼーションの直接的な検出が可能であることが示された。

AETのSAMは上記のように多くの応用例があるが、アルキル鎖が短いため、吸着質間の分子間相互作用が弱く、寝た状態で吸着し、配向性が低い。配向性が低いと、その後導入される 官能基の配向性も必然的に低くなるという問題がある。単結晶金(111)電極をmM (mmol L⁻¹) 濃度のAET溶液に50 °Cで30 min浸漬させて形成されたAETのSAMは、金表面の原子に対し て(7×√3)構造をとることが報告されている²⁹。しかし、多結晶金電極上におけるAETの吸着に 関する詳細な報告はない。AETをアンカーとして金基板に機能性分子を修飾する場合、準備が 容易であり、かつ1.5節で述べるように凹凸が大きい方が有利であることから、多結晶金電極が よく用いられる。したがって、AETの多結晶金電極への吸着特性を評価することは重要である。 1.4 キノン類

1.4.1 キノン類

キノン類は、ベンゼン環に結合する2つの水素原子が2つの酸素原子に置き換えられケトン基 を2個有する構造を持つ化合物の総称であり、ベンゾキノンやアントラキノン、ナフトキノンなど が代表例として挙げられる。キノン類には様々な誘導体が存在しており、光合成反応中心、ミト コンドリアのATP合成や神経伝達系における電子や水素のキャリアなど、生物学的に重要な役 割を果たしている。また、抗生剤や抗菌剤などの薬理作用を持っており、医薬分野でも利用さ れている。生体内においてもアカルボキシラーゼの補助因子であるビタミンKを初めとする数多 くのキノン化合物が存在することが知られている。さらに、酸化還元剤や染料としても使用され ており、工業的にも欠かせない物質である。

キノン類の中で最も単純かつ典型的なものとしてp-ベンゾキノン(ベンゾキノン(Q)とする)とp-ヒドロキノン(ヒドロキノン(QH₂)とする)が知られている(以下、これらを総称する場合はQ/QH₂と する)。酸化体であるQは一般に重合禁止剤として用いられている。また、還元体であるQH₂は、 写真現像剤、酸化および重合防止剤の他、シミの原因であるメラニン生成を抑制する美白剤成 分として知られている。 1.4.2 キノン類の電気化学

キノン類の電気化学的な特性評価は1世紀近く前から行われており、水溶液および非水溶液 中における、電極の材料や前処理、pHの違いによる挙動の違い、速度論に関する研究が数多 く行われている⁴²。

キノン類の中で最も構造が単純であるQ/QH2の酸化還元反応は、キノン類の電気化学的特 性を理解するためによく研究されている。その反応は低pHでは電気化学的に可逆であり、一般 的にはEq. 1-8のように2電子2プロトン反応として表わされる。2電子2プロトン反応を詳細に表 すとScheme 1-1のような3×3配列の反応経路が考えられる^{42,43}。しかし、その電子移動は内圏 型反応であり、複雑な挙動を示す。内圏型電子移動反応とは、いくつかの素反応を含み、反応 中間体が存在したり、反応物質の構造が変化する場合を指す。内圏型電子移動反応は電極と の相互作用が強く、電極の表面状態に依存しやすい。以下にキノン類の具体的な電気化学挙 動を示す。

$$\stackrel{OH}{\underset{OH}{\longrightarrow}} \quad \stackrel{Ox}{\underset{Red}{\longrightarrow}} \quad \stackrel{O}{\underset{O}{\longrightarrow}} \quad + 2H^{+} + 2e^{-}$$
 (1-8)



Scheme 1-1 Nine-membered square scheme for Q/QH₂.

Quanら⁴³はpH 7.2の非緩衝溶液(電解質: 0.5 M塩化カリウム)中においてQを出発物質とし て還元掃引から始めたCVと、逆にQH₂を用いて酸化掃引から始めたCVとを比較した。酸化ピ ーク電位($E_{p,a}$)はQのCVでは-0.1 V vs. SCE、QH₂のCVでは+0.3 Vであり、還元ピーク電位 ($E_{p,c}$)はQのCVでは-0.18 V、QH₂のCVでは-0.12 Vであった。酸化還元の両方においてピー ク電位は一致しなかった。一方、溶液にリン酸二水素カリウム/リン酸水素ニカリウムを加えpH 7.2の緩衝溶液とした場合、両者のピークは一致したことから($E_{p,a}$: +0.2 V、 $E_{p,c}$: -0.1 V)、ここ では2電子2プロトン反応を伴うEq. 1-8の反応が起こっているとされた。非緩衝溶液中のピーク 電流値は緩衝溶液中のそれとほぼ同じ大きさを示したことから、非緩衝溶液中でも2電子反応 が起こっていると考えられている。さらに、非緩衝溶液中におけるQH₂のCV測定において水酸 化物イオンを2当量加えるとQのCVとほぼ一致したことから、Qの非緩衝溶液中でのCVにおけ る還元反応では脱プロトン化したヒドロキノン(Q²⁻)が生成するとされている。これらのことから 非緩衝溶液中におけるQ/QH₂の酸化還元反応は、[H⁺] > [Q]の場合にはEq. 1-8であり、[H⁺] < [Q]の場合にはプロトン移動を伴わないEq. 1-9であるとされている。

また、QH₂を含む非緩衝溶液中における式量電位 E° が緩衝溶液中の E° よりも高いこと も報告されている⁴³。これは、非緩衝溶液中では Q^{2-} が生成し、均一化反応が起こるため である(Eq. 1-10)。 Q^{-}/Q^{2-} の E° は Q/QH_2 の E° よりも高いため、非緩衝溶液中では E° が高 くなる。

Homogeneous reaction

$$Q \xrightarrow{2e^{-}} Q^{2-} \xrightarrow{Q} 2Q^{-} \xrightarrow{2e^{-}} 2Q^{2-}$$

$$E^{\circ}_{Q/Q^{2-}} < E^{\circ}_{Q^{-}/Q^{2-}}$$
(1-10)

より広いpH範囲で安定なアントラキノン水溶液中において半波電位をpHに対してプロットすると、緩衝溶液中では、傾きが約-60 mV/pHとなる⁴³。25°Cにおけるネルンストの式は-m/n 59 mV/pH (m: プロトン数、n: 電子数)となり、アントラキノンの酸化還元反応はEq. 1-8と同様に2電子2プロトン反応であると述べられている。一方非緩衝溶液中では、低pH (2-4)では2電子2プロトン反応であるが、高pH (4以上)では半波電位はpH に依存しないことからプロトンが関与しない2電子移動反応(Eq. 1-9)とされている。

1.4.3 キノン類の電極表面への吸着

キノン類は炭素⁴⁴⁻⁴⁹や白金⁵⁰⁻⁵⁶、パラジウム^{57,58}、金^{59,60}など様々な種類の電極に吸着することが報告されている。

炭素電極への吸着に関する報告は数多い⁴⁴⁻⁴⁹。吸着特性は主に電気化学的手法により評価 されている。高配向熱分解グラファイト電極へのキノン類の吸着^{44,45}は、電極表面の電子的摂 動の変化に起因し、吸着の相互作用はπ-π相互作用や水素結合であるとされている⁴⁴。また、 グラッシーカーボン電極にQH₂やカテコールが吸着すると、それらの電極反応速度が速くなる ^{46,47}。この理由として、吸着による内圏再形成エネルギーの緩和⁴⁶や、吸着種と溶存種間の水 素結合⁴⁷が考えられている。

炭素電極に吸着したキノンの応用も報告されている。高配向熱分解グラファイト電極へ吸着し たキノン類は、セミキノンラジカルに還元されると酸素の還元反応を触媒することから、過酸化 水素の合成への応用が期待されている⁴⁵。QH2が吸着した活性木炭のレドックスキャパシタへ の応用では、QH2は活性木炭上のカルボニル基と水素結合を形成して吸着すると、QH2のヒド ロキシ基の解離エネルギーが低くなりプロトンが移動し易くなるために、全体の酸化還元反応 が速くなるとされている⁴⁸。さらに、カテコールの酸化によってグラッシーカーボン電極に吸着し たの-ベンゾキノンは、低い電位でNADHの酸化に対して触媒活性を示す⁴⁹。

HubbardらはQH₂やその類縁体の白金への吸着に関して数多く報告している⁵⁰⁻⁵⁶。そこでは 電気化学測定法や反射吸収赤外分光法、オージェ電子分光法、電子エネルギー損失分光法、 および低速電子線回折を用いて吸着特性を評価している。薄層電極を用いて電気化学的に求 めた1分子あたりの占有面積の値(σ)と、共有結合とファンデルワールス半径を考慮した σ を比 較することにより、吸着分子の配列を検討している⁵⁰。それにより、多結晶白金電極に吸着した QH₂は溶液濃度によって Γ や配列が変化することが明らかにされている⁵¹。また、白金電極表 面における白金原子の配列により、吸着するQH₂分子の配列も変化する⁵²。さらに、電子エネ ルギー損失分光法により電極表面の官能基を測定したところ、QH₂が吸着するとヒドロキシ基 の量が減少したことから、QH₂は酸化的に化学吸着しキノン型で吸着する可能性が考えられて いる^{53,54}。

KimおよびSoriagaらは、高分解能電子エネルギー損失分光法⁵⁷、電気化学STM^{57,58}および 電気化学測定法を用いて^{57,58}、QH₂およびQのパラジウムへの吸着を評価している。そこでは、 高分解能電子エネルギー損失分光測定から、QH₂は酸化されQとしてパラジウム電極上に少し 傾いて化学吸着することが明らかにされた。一方、パラジウム上に吸着したQはQのままであっ た。電気化学STM測定の結果から、QH₂は単結晶パラジウム(111)面に対して(3×3)の吸着格 子を形成して吸着していることが明らかにされている。

現像液成分の金電極への吸着が報告されている。銀の還元剤であるQH₂はpH 10.5の緩衝 溶液(0.54 M硝酸カリウムを含む0.2 Mホウ酸緩衝溶液)中において、未処理の多結晶金電極 に弱く吸着することが、電気化学測定を用いて評価された⁵⁹。しかし、その吸着は弱いため、現 像液の成分である亜硫酸塩やヨウ化物などの他の化合物によって簡単に置換された。そのた め、QH₂の吸着の詳細は検討されていない。また硫酸水溶液中において電気化学的に酸化処 理した金電極にはQH₂はπ電子を通して吸着することが、電気化学測定および表面増強ラマン 散乱法により明らかにされている⁶⁰。しかし、一般的な水溶液中における未処理の金電極への 吸着は報告されておらず、吸着特性の詳細は明らかになっていない。

1.5 本研究の目的と意義

前述したように、チオール基の金への高い結合力を利用した自己組織化法は、単分子 膜を容易に作成することができるため、非常に幅広く用いられている。炭素鎖が15以上 のアルキルチオールは、配向性の高い単分子膜を形成するため、末端に種々の官能基を 導入したものが機能性単分子膜を作製するためによく用いられている。一方、官能基と 電極との電子移動の観点からは、炭素鎖が長いほど不利になる。そのため、吸着密度や チオール分子の配向性は低くなるものの、鎖長が短いアルキルチオールが多く用いられ ている。末端に反応性の高いアミノ基を有するAETは、その目的で最もよく用いられる重 要な物質である²⁻⁶。しかし、配向性が低いため、その後導入される官能基の配向性も必 然的に低くなるという問題を抱えている。SAMを電極触媒反応やセンシングなど実際に応 用する際には、準備が容易であり、凹凸が大きい方が修飾分子を物理的に固定しやすいこと から、多結晶金電極がよく用いられる。しかし、AETの多結晶金電極への吸着に関する詳細な 報告はない。そこでAETの多結晶金電極への吸着の速度論的および熱力学的特性を詳細に 評価することを目的とした。

チオール基などの吸着基を持たない分子も、ファンデルワールスカや水素結合など 様々な相互作用により電極に吸着する。これらも分子機能電極として働く。本研究では、QH₂ が多結晶金電極に吸着することを見出した。その吸着を詳細に検討するために、QH₂の金 電極への吸着の速度論的および熱力学的特性評価を行った。1.4.3節で述べたように、QH₂ あるいはQが白金⁵⁰⁻⁵⁶やパラジウム^{57,58}、炭素電極⁴⁴⁻⁴⁹へ吸着することは報告されているが、 活性化処理などを施していない金電極への報告はない。白金やパラジウムなどの触媒作 用が高い金属への吸着は主に化学結合の形成、sp²構造および酸素含有官能基を持つ炭素 電極への吸着は主にπ-π相互作用や水素結合により起こる。一方、金電極ではこれらのよ うな相互作用が起こりにくいと考えられるため、QH₂の吸着は非常に興味深く、このメカ ニズムを解明できれば、他の小分子吸着のモデルと成り得、触媒やセンサ等への応用の 基礎的な知見となると考えられる。

キノンの電気化学的研究に関する報告は数多くあるが、その酸化還元反応は、電極の 違いや、溶液のpHや緩衝能の有無により経路が異なるため⁴³、未解明な点が多く存在す る。また、その反応は内圏型電子移動であるため、Q/QH₂の電子移動は電極表面状態に強 く依存する。本研究では、金表面に吸着したQH₂が溶存種の電子移動速度に影響を与える ことを見出した。同じ化学種の吸着によりその電子移動が速くなることは他の化学種に おいても報告されているが、自種の電子移動を妨害する現象は新しい。吸着したQH₂が全 体の酸化還元反応に影響を与えている可能性が高いことから、これまで未解明な部分が 多かったキノンの酸化還元反応のメカニズム解明に向けて、重要な役割を果たすものと 期待される。さらに、QH₂の吸着により溶存種の電子移動を制御できる可能性があること から、センサ等への応用も期待される。

本論文は以下のように構成される。

第1章は序論であり、本研究の背景と目的について述べた。

第2章では、AETの金電極への吸着特性評価について述べた。評価方法は、CVによる還 元脱離法を用いた。還元脱離電位により、AETが多結晶金上のどの結晶面に吸着するか、 また吸着したAET膜の安定性を明らかにした。さらに、AETの多結晶金電極上への吸着を 速度論的および熱力学的に評価した。

第3章では、QH₂の金電極への吸着特性評価について述べた。評価方法は、CVおよび飛行時間型二次イオン質量分析法(TOF-SIMS)を用いた。QH₂の多結晶金電極上への吸着を 速度論的および熱力学的に評価し、さらに吸着へのpHの影響や脱離条件を明らかにした。

第4章では、金電極へ吸着したQH2の溶存種の電気化学特性への影響について述べた。 CVを用いて、外圏型および内圏型電子移動を伴う酸化還元活性種の応答に対する、吸着 したQH2が与える影響を明らかにした。

第5章では、これらの内容を総括した。

第2章 アミノエタンチオールの多結晶金電極への

吸着特性評価

2.1 緒言

アルキルチオールなどのSAMは、電極表面特性の改変や新たな機能を発現させること ができることから、非常に幅広く用いられている。炭素鎖が2と短く、末端に反応性の高 いアミノ基を有するAETは、電極表面の電荷や疎水性の制御や、機能性分子を固定化する ためのアンカーとして利用されている。しかし、配向性が低いため、吸着状態の研究も あまり行われておらず、その後導入される官能基の配向性も必然的に低くなるという問 題を抱えている。また、SAMを実際に利用する際には、多結晶金電極がよく用いられるが、 AETの多結晶金電極への吸着に関する詳細な報告はない。そこでAETの多結晶金電極への 吸着の速度論的および熱力学的特性を詳細に評価することを目的とした。

本章では、AETの多結晶金電極上への吸着をCVによる還元脱離法を用いて評価した。還 元脱離電位により、AETが多結晶金上のどの結晶面に吸着しているか検討し、また吸着した AET膜の安定性を評価した。吸着過程を吸着質および溶媒の競争反応と見なした際の、吸着 の速度論的および熱力学的評価方法を検討した。さらに、これらの方法に基づいて、AETの 多結晶金電極上への吸着を評価した。速度論では吸着律速および拡散律速の場合を検討した。 吸着の熱力学的評価ではLangmuirおよびFrumkin吸着等温式を用いて検討した。 2.2 実験

2.2.1 試薬および装置

エタノール(特級、和光純薬)、AET(和光純薬)、水酸化カリウム(BioXtra、Aldrich)あるいは (特級、和光純薬)、硫酸(高純度特級、和光純薬)、重水(99.8%D、NMR用、関東化学)はその まま用いた。全ての実験において純水は超純水製造装置(Direct-Q[®] 3 UV、ミリポア)により精 製したものを使用した。電気化学測定にはポテンショスタット(Hz-5000、北斗電工)を用いた。参 照電極にはダブルジャンクション付きAg/AgCI電極(インターケミ)、対極にはPt巻線を用いた。 超音波照射にはバス型超音波洗浄器(UT-105S, Sharp)を用いた。真空蒸着は、高真空抵抗 加熱蒸着装置(JIS-300AK、シンク)を用いた。パルス磁場勾配核磁気共鳴(PFG-NMR)測定は、 超伝導高分解能核磁気共鳴装置(ECZ700R、JEOL RESONANCE)により行った。

2.2.2 金電極の洗浄

多結晶金ディスク電極(直径1.6 mm, BAS)をアルミナ懸濁液(粒径: 0.05 μm、リファインテッ ク)で研磨し超純水で洗浄した後、超音波を3 – 5 min間照射した。0.1 M硫酸水溶液中におい て+1.5および–0.1 V vs. Ag/AgClをそれぞれ30 sずつ印加し、その後5 V s⁻¹で清浄な金表面 のボルタモグラムが得られるまで掃引し、電気化学的に洗浄した。多結晶金電極のラフネスを 考慮した実際の表面積は、0.1 M硫酸水溶液中において100 mV s⁻¹で掃引したCVにおける酸 化被膜形成時のピーク電気量から求めた⁶¹。算出方法については2.3.1節で詳しく述べる。電 気化学的洗浄には研究室製の三又セルを用いた。作用電極を設置した区画の溶液を10 min 間窒素脱気した後、測定中は液面上に窒素を流した。測定は全て室温(25±1 °C)で行った。

2.2.3 アミノエタンチオールの金電極への吸着

洗浄した金電極を1 – 100 µMのAETエタノール溶液(20 mL)に時間を変えて浸漬させ、電極 表面にAETの単分子膜を形成させた。その後、エタノールおよび純水で洗浄し、AET修飾金電 極とした。

2.2.4 還元脱離法による吸着したアミノエタンチオールの定量

AET修飾金電極を0.1 M水酸化カリウム水溶液中に移し、10 mV s⁻¹においてCV測定を行い、 充電容量を引いた還元脱離ピーク電気量から金電極へ吸着したAETの*I*を算出した(Eq. 2-1)。

$$\Gamma = \frac{\int i(t)dt}{nFA}$$
(2-1)

i: 電流、*n*: 反応電子数、*F*: ファラデー定数、A: 電極面積 電気化学測定にはバイアルセル(50 mL)を用いた(Fig. 2-1)。0.1 M水酸化カリウム水溶液を30 min間窒素脱気した後、測定中は液面上に窒素を流した。



Figure 2-1 Schematic illustration of electrochemical cell for measurement of surface coverage of AET adsorbed on polycrystalline gold electrode.

2.2.5 単結晶金(111)電極の作製および電気化学測定

マイカ(厚さ0.4 - 0.45 mm、天然マイカ、ニラコ)を14 mm × 14 mmに切断し、新しい面が出 るよう劈開した後、高真空抵抗加熱蒸着装置内に設置した。この際、専用のサンプルホルダー を使用した。装置のチャンバー内の圧力を約10⁻⁴ Paまで下げ、300 °Cで約2 hベーキングした 後、金を200 nm蒸着した。その後、金蒸着マイカを水素炎で90 sアニールしたものを単結晶金 (111)電極とした⁶²。なお、(111)面が露出していることは硫酸水溶液中におけるCVの酸化被膜 形成のピーク電位により確認した。

電気化学測定には、研究室製のマイカ基板金電極用セルを用いた(Fig. 2-2A)。作用電極は O-リング(直径: 4.8 mm、ニトリルゴム)により面積規制し(0.181 cm²)、ポテンショスタットとの導 通には銅テープ(幅: 10 mm、厚さ: 0.070 mm、寺岡製作所)を用いた(Fig. 2-2B)。なお銅テー プと溶液は接触しない。また作用電極と参照電極との距離を近づけるために(約2 mm)、ダブル ジャンクションの参照電極のホルダーにディスペンサーピペットのチップ(200 μl用、Porex Bio Products)を装着した(Fig. 2-2C)。



Figure 2-2 Electrochemical cell for vacuum deposited gold electrode. (A) Schematic illustration of the cell, (B) detailed cross-section of the electrode part, and (C) experimental setup.

AETをNMRサンプル管に適量入れ、溶媒として重水を加えた。PFG-NMR測定は、磁場勾配 を0.003 - 0.90 T m⁻¹、パルス間隔を20 s、パルス長を0.5 msとして行った。

2.3 結果と考察

2.3.1 電極表面積の定量および結晶面の同定

金属電極において、水の電気分解により酸素発生反応を起こす場合、酸素ガスが発生する 前に酸素は表面の金属原子と1:1で化学吸着し、単原子の酸化被膜が形成される⁶¹。そのため、 酸化被膜形成時の電気量Q₀は、酸素原子の表面濃度*Γ*₀と相関がある。

$$Q_0 = 2eN_A\Gamma_0A \tag{2-2}$$

e: 電気素量、NA: アボガドロ定数

酸素は金属原子と1:1で吸着するため、Γ₀は金属原子の表面密度と等しくなる。酸素原子が密 に金属原子に吸着した際の電気量をQ₀^Sとすると、表面積AはEq. 2-3で表される。

$$A = \frac{Q_0}{Q_0^S} \tag{2-3}$$

多結晶金電極の Q_0^{s} は390±10 μ C cm⁻²である⁶¹。Equation 2-3に基づいて、多結晶金電極の 実際の電極面積を見積もることができる。

多結晶金電極を電気化学的に洗浄した後の0.1 M硫酸水溶液中における100 mV s⁻¹のCV をFig. 2-3に示す。+1.1 V vs. Ag/AgClからの酸化電流は酸化被膜の形成反応に対応しており、 その電気量から実際の電極表面積を算出した。算出を全ての測定で行ったところ、実際の表面 積は0.041±0.015 cm²となり、幾何学的面積が0.020 cm²であることからラフネスファクター $R_{\rm f}$ は2.0であった。

多結晶金電極において、酸化被膜形成の酸化電流は+1.1 Vから+1.5 Vにかけて流れている ことから、様々な結晶面が露出した多結晶状態になっていることがわかる。その中で3つの明確 な酸化ピークが出現しており、電位は+1.15、+1.23、+1.34 Vであった(Fig. 2-3)。単結晶金 (100)および(111)電極における酸化被膜形成のピーク電位は+1.23 V⁶³および1.35 V⁶⁴である ことが報告されている。これらのことから+1.23 Vおよび+1.34 Vの酸化ピークは、それぞれ多 結晶金電極の(100)および(111)面上への酸化被膜の形成に対応していることが示された。ま た、マイカ上に蒸着した金電極の酸化被膜形成のピーク電位は+1.35 Vであった(Fig. 2-4)。こ のことから、この電極が単結晶金(111)であることが確認された。


Figure 2-3 Cyclic voltammogram of polycrystalline gold electrode in 0.1 M H_2SO_4 solution after electrochemical cleaning. Scan rate was 100 mV s⁻¹.



Figure 2-4 Cyclic voltammogram of single-crystalline gold (111) electrode in 0.1 M H_2SO_4 solution. Scan rate was 50 mV s⁻¹.

2.3.2 アミノエタンチオールの還元脱離電位

100 µM AETエタノール溶液に3 h浸漬させた多結晶金電極の0.1 M水酸化カリウム水溶液 中におけるCVをFig. 2-5に示す。1サイクル目において(Fig. 2-5 curve a)、-0.63、-0.80および -1.0 Vに還元ピークが出現し、2 - 5サイクル目には現れなかった(Fig. 2-5 curve b - e)。した がって、これらのピークはAETの金表面からの脱離反応に対応していることが示された。

大坂らは、多結晶金^{22,23}、単結晶金(111)、(100)、(110)²²電極に吸着したシステイン^{22,23}およ び4-メルカプト安息香酸²²の還元脱離反応について報告している。単結晶金(111)、(100)、 (110)電極上に吸着したそれらの還元脱離ピーク電位は、金(111)、(100)、(110)電極の順に低 くなった。多結晶金電極上に吸着した場合では、還元ピークは3つ出現し、それらの電位は単結 晶金(111)、(100)、(110)電極に吸着した場合とよく一致した。したがって、多結晶金電極での3 つの還元ピークは、正側から順に金(111)、(100)、(110)面に吸着したシステインおよび4-メル カプトエタノールの脱離ピークとされている。またYangらは、単結晶金電極に吸着したノナンチ オールの還元脱離電位について、未修飾の単結晶金電極のゼロ電荷電位と相関性があると 述べている²⁵。

多結晶金表面には多くの欠陥やステップが存在しているが、面心立方格子である金の多結 晶表面は(111)、(100)、(110)面の3つの低指数面で主に構成されている⁶⁵。さらに、単結晶金 (111)電極に吸着したAETの0.1 M水酸化カリウム水溶液中におけるCVでは、-0.63 Vに鋭い 還元ピークが出現した(Fig. 2-6)。他のピークは何由来かは不明だが、-0.63 Vの還元反応は 金(111)面からの脱離であると考えられる。この電位は多結晶金電極にAETが吸着した際の還 元脱離電位と一致している。

これらの結果および以前の報告から、本論文における多結晶金電極に吸着したAETの-0.63、 -0.80、-1.0 Vの還元ピークは、それぞれ金(111)、(100)、(110)面に吸着したAETの還元脱離 反応に対応していると考えられる。したがって、多結晶上の金(111)、(100)、(110)面に吸着した AET単分子膜の安定性は、(111)、(100)、(110)の順に高くなることも明らかになった。



Figure 2-5 Typical cyclic voltammograms of polycrystalline gold electrode, which was immersed in 100 μM AET ethanol solution for 3 h, at (a) 1st, (b) 2nd, (c) 3rd, (d) 4th, (e) 5th cycle, and of (f) bare polycrystalline gold electrode in 0.1 M KOH solution. A typical base line to calculate surface coverage was shown as a curve g. Scan rate was 10 mV s⁻¹.



Figure 2-6 Cyclic voltammogram of single-crystalline gold (111) electrode, which was immersed in 10 mM AET ethanol solution (5 mL) for 22 h, in 0.1 M KOH solution. Scan rate was 10 mV s⁻¹.

電極/溶液界面における吸着過程は、電極表面の吸着サイトに対する溶液中の吸着質分子 や溶媒、イオンの競争反応と見なすことができ^{66,67}、以下のような平衡が成り立つ。

$$A_{(sol)} + S_{(ads)} \rightleftharpoons A_{(ads)} + S_{(sol)}$$
(2-4)

A_(sol): 溶液中の吸着質、S_(ads): 電極表面に吸着した溶媒やイオン

A_(ads): 電極表面に吸着した吸着質、S_(sol): 吸着質と置き換わった溶媒やイオン この吸着平衡において系の電気化学ポテンシャル_{*ū*i}は、次式で表される。

$$\bar{\mu}_{A_{(sol)}} + \bar{\mu}_{S_{(ads)}} = \bar{\mu}_{A_{(ads)}} + \bar{\mu}_{S_{(sol)}}$$
 (2-5)

電気化学ポテンシャルは、標準化学ポテンシャル μ°_{i} および活量aを用いて表すと、以下の 式が得られる。

$$\bar{\mu}^{\circ}{}_{A_{(\text{sol})}} + RT\ln a_{A_{(\text{sol})}} + \bar{\mu}^{\circ}{}_{S_{(\text{ads})}} + RT\ln a_{S_{(\text{ads})}} = \bar{\mu}^{\circ}{}_{A_{(\text{ads})}} + RT\ln a_{A_{(\text{ads})}} + \bar{\mu}^{\circ}{}_{S_{(\text{sol})}} + RT\ln a_{S_{(\text{sol})}}$$

$$(2-6)$$

この式を書き換えると

$$\frac{a_{A_{(ads)}}}{a_{S_{(ads)}}} = \left[\exp\left(-\frac{\Delta G^{\circ}}{RT}\right) \right] \frac{1}{a_{S_{(sol)}}} \cdot a_{A_{(sol)}}$$
(2-7)

ここでΔG°は吸着のギブスの自由エネルギーであり、次式で表される。

$$\Delta G^{\circ} = \bar{\mu}^{\circ}{}_{A_{(ads)}} + \bar{\mu}^{\circ}{}_{S_{(sol)}} - \bar{\mu}^{\circ}{}_{A_{(sol)}} - \bar{\mu}^{\circ}{}_{S_{(ads)}}$$
(2-8)

溶液中の吸着質と溶媒の活量は溶液濃度とほぼ同じとみなすと

$$a_{A_{(sol)}} \approx C_A^*$$
 (2-9)

$$a_{\mathrm{S}_{\mathrm{(sol)}}} \approx C_{\mathrm{S}}$$
 (2-10)

*C*_A^{*}: 吸着質のバルク溶液濃度、*C*_S: 溶媒の濃度

さらに、 $a_{A_{(ads)}}$ は一般的に表面被覆率 $\theta(\Gamma_{t}/\Gamma_{s})$ 、 $a_{S_{(ads)}}$ は1- θ で表される。

$$a_{A_{(ads)}} = \frac{\Gamma_{t}}{\Gamma_{s}} = \theta$$
 (2-11)

$$a_{\mathrm{S}_{(\mathrm{ads})}} = \frac{\Gamma_{\mathrm{s}} - \Gamma_{\mathrm{t}}}{\Gamma_{\mathrm{s}}} = (1 - \theta)$$
(2-12)

Γ_i:時間 *t* における A_(ads)の表面濃度、Γ_s: 飽和表面濃度

Equation 2-9 から 2-12 を Eq. 2-7 に代入すると

$$\frac{\theta}{1-\theta} = \left[\exp\left(-\frac{\Delta G^{\circ}}{RT}\right) \right] \frac{1}{C_{\rm s}} \cdot C_{\rm A}^{*}$$
(2-13)

温度一定下では、指数項が一定となるため、Eq. 2-13 は以下の様に表すことができる。

$$\frac{\theta}{1-\theta} = \beta C_{\rm A}^* \tag{2-14}$$

ここでβは吸着係数であり、以下の式で表すことができる。

$$\beta = \left[\exp\left(-\frac{\Delta G^{\circ}}{RT}\right) \right] \frac{1}{C_{\rm s}}$$
(2-15)

これを書き換えると

$$\Delta G^{\circ} = -RT ln(C_{\rm s}\beta) \tag{2-16}$$

Equation 2-14 は Langmuir 吸着等温式であり、これは吸着質間の相互作用がなく、1 つ の吸着サイトあたりに 1 つの吸着質分子が吸着し、単分子層を形成する時に成り立つモ デルである。全ての吸着サイトが吸着質分子で満たされると、 Γ_s に達する。また、求め $t\beta$ から Eq. 2-16 を用いて ΔG° を算出することができる。

Langmuir 吸着等温式では、吸着質間同士の相互作用は考慮されていない。しかし、吸 着質間に引力や斥力が存在する場合には、Langmuir 吸着等温式に指数項が追加される。 吸着質間の相互作用を考慮したものの一つに Frumkin 吸着等温式があり、次式で表すこ とができる^{67,68}。

$$\frac{\theta}{1-\theta} \exp(-2g\theta) = \beta C_{\rm A}^*$$
(2-17)

g: 相互作用パラメータ

吸着質間同士の相互作用がない場合にはg=0となり Langmuir 吸着等温式になる。引力 が存在する場合にはg > 0となり、斥力が存在する場合にはg < 0となる。

Equation 2-4の平衡における反応速度を考える。vfとvbは次式で表される。

$$v_{\rm f} = k_{\rm f} a_{\rm A_{(sol)}} a_{\rm S_{(ads)}} \tag{2-18}$$

$$v_{\rm b} = k_{\rm b} a_{\rm A_{(ads)}} a_{\rm S_{(sol)}} \tag{2-19}$$

kf: 吸着反応速度定数、kb: 脱離反応速度定数

Equation 2-9 から 2-12 を Eq. 2-18 および 2-19 に代入すると

$$v_{\rm f} = k_{\rm f} C_{\rm A}^* (1 - \theta)$$
 (2-20)

$$v_{\rm b} = k_{\rm b} \theta C_{\rm S} \tag{2-21}$$

平衡状態では、吸着速度と脱離速度は等しいため⁶⁹

$$k_{\rm f}C_{\rm A}^*(1-\theta) = k_{\rm b}\theta C_{\rm S} \tag{2-22}$$

$$\frac{\theta}{1-\theta} = \frac{k_{\rm f}}{k_{\rm b}} \cdot \frac{1}{C_{\rm S}} \cdot C_{\rm A}^* \tag{2-23}$$

Equation 2-23 は Langmuir 吸着等温式の別の形であり、Eq. 2-14 と等しい。したがって、 β は反応速度定数を用いて表すことができる。

$$\beta = \frac{k_{\rm f}}{k_{\rm b}} \cdot \frac{1}{C_{\rm S}} \tag{2-24}$$

Equation 2-4 の平衡において、吸着過程全体の反応速度 v (d θ /dt)は、吸着速度と脱離速度の差($v_{\rm f} - v_{\rm b}$)で表される。

$$v = \frac{d\theta}{dt} = v_{\rm f} - v_{\rm b} = k_{\rm f} C_{\rm A}^* (1 - \theta) - k_{\rm b} \theta C_{\rm S}$$
 (2-25)

Equation 2-24 を代入すると

$$v = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = k_{\mathrm{f}} \left[C_{\mathrm{A}}^* (1-\theta) - \frac{1}{\beta} \theta \right]$$
(2-26)

本研究の系では、 β は AET の場合では 1.0 × 10⁶ L mol⁻¹ (2.3.4.2 項で詳細に述べる)であるため、1/ β ≪ 1 となり、Eq. 2-26 の第三項は無視できるほど小さく、次のように近似される。

$$v = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = k_{\mathrm{f}} C_{\mathrm{A}}^* (1 - \theta) \tag{2-27}$$

Equation 2-27 は吸着速度を表した Eq. 2-18 と同じであることから、本研究の系では全体の反応速度 v を求める際に脱離速度を無視できる。微分方程式で表された速度式は、任意の時間での反応速度を与え、ここから導かれる積分形速度式は、「を時間の関数として与える。

$$\Gamma_{\rm t} = \Gamma_{\rm s} \left(1 - \exp\left(-k_{\rm f} C_{\rm A}^* t\right) \right) \tag{2-28}$$

この式をより一般的な形で表すと

$$\Gamma_{\rm t} = \Gamma_{\rm e} (1 - \exp(-k_{\rm f} C_{\rm A}^* t))$$
 (2-29)
 $\Gamma_{\rm e}$: 平衡時の表面濃度

この速度式は Langmuir 型の吸着を示し吸着過程が律速となる場合に用いられる。

吸着が強く、その速度が速い場合には拡散律速となる。この時、電極表面が吸着質で 完全に覆われるまでは、電極近傍の溶液層における吸着質の濃度がほぼ 0 となる。この ような条件下では次式が成り立つ⁷⁰。

$$\frac{\Gamma_{\rm t}}{\Gamma_{\rm s}} = \frac{C_{\rm A}^*}{b\pi} (\frac{4\pi b^2 Dt}{{\Gamma_{\rm s}}^2})^{1/2}$$
(2-30)

b: 等温線係数

D: 溶液中における吸着質の拡散係数

書き換えると

$$\frac{\Gamma_{\rm t}}{\Gamma_{\rm s}} = K \left(\frac{C_{\rm A}^*}{\Gamma_{\rm s}}\right) (Dt)^{1/2} \tag{2-31}$$
$$\mathcal{K} = 2\pi^{-1/2}$$

この速度式は拡散律速モデルである。

2.3.4 吸着特性評価

2.3.4.1 速度論的評価

1 – 100 μMのAETエタノール溶液へ浸漬させた多結晶金電極の、浸漬時間に対するДのプ ロットをFig. 2-7に示す。Figure 2-7で示されるように、検討した全ての溶液濃度において」は浸 漬時間に対して増加した。図中の曲線は、Γ_eおよびk_fを未知パラメータとして、Langmuir吸着律 速モデル(Eq. 2-29)へ最小二乗法を用いてフィッティングを行ったものである。検討した全ての 溶液濃度においてプロットと曲線はほぼ一致したことから、AETの多結晶金電極への吸着は吸 着律速モデルで表される可能性が考えられた。20 μM以下のAET溶液の場合では、Γは30 min以内で平衡に達したのに対し、35 μM以上の場合では吸着が速く、Πは約5 min以内で平衡 に達した。これまでに、長鎖アルキルチオールの金(111)表面への吸着に対する速度論につい て報告されている(1.3.2節)^{17,18}。吸着の第一段階は、吸着質が表面に吸着する過程であり、第 二段階は表面の結晶化過程と呼ばれており、配向性の低いアルキルチオールは二次元の結 晶を形成する。したがって、本論文のAETの多結晶金への吸着も、「が浸清時間に対して大き く増加している時間範囲は第一ステップ、「が時間に対してほぼ一定である時間範囲は第二ス テップであると考えている。2-メルカプトエタノールが金電極に吸着する際の平衡到達時間は、 溶液濃度が2、20、200 μMのとき、それぞれ3 min、30 s、10 sであることが報告されている²⁷。 これらの時間は本論文の値よりも短かかったことから、アルキルチオールの官能基は吸着速度 に影響すると考えられる。

Langmuir吸着律速モデル(Eq. 2-29)へフィッティングしたことにより得られた Γ_e および k_f を Table 2-1に示す。 Γ_e の値は、35 μ M以下のAET溶液の場合では溶液濃度が高くなるほど高く なったのに対し、35 μ Mより高濃度ではほぼ一定と考えられた。したがって、今回の系において、 Eq. 2-4の平衡式が吸着平衡を示し、吸着の速度論は吸着律速モデルによって表される可能 性が示された。このような条件下では、系が吸着平衡に達してから十分な時間が経過したあと、 電極近傍の溶液濃度はバルクの溶液濃度に達するため、 Γ_e はAETの溶液濃度に依存する⁶⁶。 さらに、2-メルカプトエタノールが金電極(R_f : 1.17)に吸着する際の Γ_e の値(4.47 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²)²⁷とほぼ一致したことから、今回の Γ_e の値は妥当であることが示された。 k_f の値はAETの 溶液濃度に依存しなかった(3.6 – 12.9 × 10² M⁻¹ s⁻¹)。ブタンチオール、ドデカンチオールおよ びドコサンチオールがエタノール中において多結晶金電極へ吸着する際の k_f の値は、それぞれ 3726、2636、2337 M⁻¹ s⁻¹であり、アルキル鎖が長くなるにつれて k_f の値は減少することが報 告されている²⁶。一方、オクタンチオールの本サン中での多結晶金電極へ吸着する際の k_f の 値(811 M⁻¹ s⁻¹)は、オクタデカンチオールの値(2440 M⁻¹ s⁻¹)よりも小さいことも報告されてい る⁷¹。したがって、アルキルチオールの多結晶金電極への吸着速度は、アルキル鎖の長さだけ ではなく、他の要因によっても影響されると考えられる。これらの値と比較して、AETのkfは小さ いことから、AETの多結晶金電極への吸着速度はあまり速くないと考えられ、この原因として AETのアミノ基間に相互作用が存在するためと考えている。

吸着が強く、その速度が速い場合には拡散律速となり、表面被覆率 Γ_i/Γ_s はEq. 2-31で表さ れる⁷⁰。AETの多結晶金電極への吸着過程が拡散律速であると仮定し、 Γ_i/Γ_s を時間の平方根 に対してプロットした(Fig. 2-8)。3 – 10 μ M AET濃度では直線関係が得られ、傾きからEq. 2-31を用いて拡散係数Dを算出したところ、0.3 – 1.5 × 10⁻⁵ cm² s⁻¹となった(Table 2-2)。水溶 液中における分子やイオンの一般的なDは10⁻⁵ cm² s⁻¹であるため、得られた値は妥当である と考えている。本実験では最も短い浸漬時間は1 minであり、 Γ は1 min以内でほぼ平衡に達し てしまったため、20 – 100 μ M AET溶液の場合では正確な傾きを求めるのが困難であったが、 2点のみの傾きからDを見積もった。20 – 50 μ Mの場合では、Dは0.1 – 0.5 × 10⁻⁵ cm² s⁻¹とな り、溶液中の種における妥当な値となった。しかし、100 μ Mの場合では、Dは0.05 × 10⁻⁵ cm² s⁻¹と溶液中の種の典型的な値よりも一桁小さく非物理的な値となった。したがって、吸着の速 度論は、3 – 50 μ Mの場合では拡散律速モデルによっても表され、100 μ Mの場合では吸着律 速である可能性が示された。

ー方、上述したように、検討した全ての溶液濃度において、実験値とLangmuir吸着律速モデ ルはほぼ一致したことから、吸着過程が律速である可能性も示された。したがって、3 – 50 μ M の場合では吸着と拡散の速度が拮抗している可能性が考えられた。そこで、溶液中のAETのD をPFG-NMR測定により求めた。PFG-NMR測定により得られたスペクトルをFig. 2-9に示す。 AETの重水中におけるDを算出したところ、2.2 × 10⁻⁵ cm² s⁻¹となった。このDの値は、3および 4 μ MのAET溶液に浸漬させた際のDと近い値であったことから、3および4 μ Mの場合では拡散 律速と考えられた。

以上の結果から、AETの多結晶金電極への吸着に対する速度論は、AET溶液が3および4 μMの場合では拡散律速、5 – 100 μMの場合では吸着律速と考えられた。



Figure 2-7 Adsorption kinetics at (A) 1, (B) 3, (C) 4, (D) 5, (E) 10, (F) 20, (G) 35, (H) 50, and (I) 100 μ M AET on polycrystalline gold electrode in ethanol solution.

<i>C</i> _A (μM)	$\Gamma_{\rm e}~(10^{-10}{\rm mol~cm^{-2}})$	$k_{\rm f} (10^2 {\rm M}^{-1} {\rm s}^{-1})$
1	3.0	NA
3	3.6	12.9
4	4.1	9.3
5	4.0	3.6
10	4.9	4.1
20	5.1	12.0
35	5.4	9.6
50	5.2	6.2
100	4.9	5.9

Table 2-1 Thermodynamic and kinetic parameters for AET from the analysis of Fig. 2-7.



Figure 2-8 Variation of normalized surface coverage as function of $t^{1/2}$ at (A) 1, (B) 3, (C) 4, (D) 5, (E) 10, (F) 20, (G) 35, (H) 50, and (I) 100 μ M AET ethanol solution.

<i>C</i> _A (μM)	$D (10^{-5} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1})$
1	NA
3	1.5
4	1.1
5	0.4
10	0.3
20	(0.5)
35	(0.2)
50	(0.1)
100	(0.05)

Table 2-2 Diffusion coefficients *D* for AET from the analysis of Fig. 2-8.Values inparenthesis were calculated using the slopes of two points.



Figure 2-9 Pulsed-field gradient NMR spectrum of AET in D₂O.

速度論的評価(2.3.4.1節)においてEq. 2-29を用いて算出した Γ_e のAETの溶液濃度に対する プロットをFig. 2-10に示す。Langmuir吸着等温式(Eq. 2-14)あるいはFrumkin吸着等温式(Eq. 2-17)どちらが今回の吸着系に適しているかを検討する前に、 Γ_s および β の値を求めた。これら の値を未知パラメータとしてLangmuir吸着等温式(Eq. 2-14)へ最小二乗法を用いてフィッティン グを行った結果をFig. 2-10 curve alc示す。得られた値は、 Γ_s は5.2 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²、 β は1.0 × 10⁶ L mol⁻¹となった。AETが単結晶金(111)表面に密に吸着した際の Π は(7× $\sqrt{3}$)構造²⁹から 6.6 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²であり、今回得られた値はこの値よりもわずかに小さかった。さらに、AET が銀表面に吸着する場合、AETはフリーのアミノ基が銀表面から離れたトランス配位異性体を 形成する、あるいはアミノ基が銀と接近し相互作用するゴーシュ配位異性体を形成することが 報告されている⁷²。得られた結果および以前の報告より、AETは多結晶金表面に寝た形で吸着 している可能性が示唆された。また他の可能性として、AETは金の結晶面により吸着の配列が 異なり、 Γ が結晶面に依存することも考えられる。

算出した β の値からEq. 2-16を用いて ΔG° を計算したところ、-41 kJ mol⁻¹となった。ビス(2-ヒ ドロキシエチル)ジスルフィドが多結晶金電極に吸着する際の ΔG° は-38 kJ mol⁻¹であると報告 されている²⁷。今回得られた値はこれよりも大きかったことから、AETの多結晶金電極への吸着 は強いと考えられる。

吸着質問の相互作用を考慮したFrumkin吸着等温式(Eq. 2-17)が今回の吸着系に適応でき るか検討した。gを未知パラメータとしてEq. 2-17を用いてフィッティングを行った(Fig. 2-10 curve b)。Γ_sおよびβの値はLangmuir吸着等温式にフィッティングして得られた値を用いた。g は0.02となり、吸着したAET分子間に弱い引力が働いていることが示された。この引力の原因 としてAET間のファンデルワールス力やアミノ基との相互作用が考えられる。しかし、gの値は 無視できるほど小さく⁷³、これはAETのアルキル鎖が短いためであると考えられる。したがって、 AETの多結晶金電極への吸着はLangmuir型であることが示された。



Figure 2-10 (a) Langmuir and (b) Frumkin isotherms fitted to the experimental points for AET adsorbed on polycrystalline gold electrode immersed in ethanol solution containing AET.

2.4 結言

本章では、AETの多結晶金電極上への吸着をCVによる還元脱離法を用いて評価した。CV では1サイクル目に-0.63、-0.80および-1.0 Vに還元ピークが出現し、それぞれ金(111)、 (100)、(110)面に吸着したAETの還元脱離反応に対応することを明らかにした。このことから、 多結晶上の金(111)、(100)、(110)面に吸着したAET単分子膜の安定性は、(111)、(100)、 (110)の順に高くなることも見出した。吸着の速度論的評価では、AET溶液が3および4 μ Mの場 合では、拡散律速モデルへよく一致し、さらにそのモデルおよびPFG-NMR測定から求めたD がほぼ一致したことから、拡散律速と考えられた。5 – 100 μ Mの場合では実験値とLangmuir 吸着律速モデルがほぼ一致したことから、吸着律速と考えられた。熱力学的評価では、 Frumkin吸着等温式のgが無視できるほど小さかったことから、AETの多結晶金電極への吸着 はLangmuir型であることが示された。 Γ_s は5.2 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²となり、AETが単結晶金(111) 表面に密に吸着した際の Γ (6.6 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²)よりも小さかったことから、AETは多結晶金 表面に寝た形で吸着している、あるいはAETは金の結晶面により吸着の配列が異なり、 Γ が結 晶面に依存することが考えられた。 第3章 ヒドロキノンの多結晶金電極への吸着特性評価

3.1 緒言

第2章では、金とチオールとの高い結合力から、化学結合を形成して吸着するAETの吸着特 性について評価した。しかし、チオールなどの吸着基を持たない分子も、ファンデルワールス力 や水素結合など様々な相互作用により電極に吸着する。これらも分子機能電極として働く。本 章では、QH2が多結晶金電極に吸着することを見出した。その吸着を詳細に検討するために、 QH2の金電極への吸着の速度論的および熱力学的特性評価を行った。はじめに、Q/QH2の基 本的な電極反応について検討し、それに基づいてQH2およびQの多結晶金電極上への吸着を CVにより評価した。QH2の吸着の速度論を、吸着律速および拡散律速モデルにより検討した。 吸着の熱力学的評価では、LangmuirおよびFrumkin吸着等温式を用いて検討した。また、吸 着したQH2の脱離条件について検討した。さらに、Q/QH2の酸化還元反応にはプロトンが関与 するため、吸着へのpHの影響についても評価した。QH2およびQの金電極への吸着を直接的 に評価するため、飛行時間型二次イオン質量分析(TOF-SIMS)測定を行った。これらの評価 は、他の小分子吸着のモデルと成り得、触媒やセンサ等への応用の基礎的な知見となる と考えられる。 3.2 実験

3.2.1 試薬および装置

QH₂ (特級、和光純薬)および過塩素酸ナトリウム(特級、和光純薬)は、それぞれエタノール およびメタノールにより再結晶して真空中で乾燥させ、精製したものを用いた。Qは昇華法によ り精製したものを用いた。過塩素酸(60%、精密分析用、和光純薬)、リン酸二水素カリウム(特 級、和光純薬)、リン酸水素二ナトリウム(特級、和光純薬)、アンモニア水(特級、関東化学)、硝 酸アンモニウム(特級、林純薬)、水酸化ナトリウム(特級、米山薬品)はそのまま用いた。pH測 定にはガラス電極(TPX-999、東興化学)を用いた。TOF-SIMS測定は、飛行時間型二次イオン 質量分析装置(PHI TRIFTV nano TOF、アルバック・ファイ)により行った。金スパッタにはスパ ッタ装置(QUICK COATING SC-701、サンユー電子)を用いた。他の試薬および装置は、2.2.1 と同じものを用いた。

3.2.2 ヒドロキノンの金電極への吸着

2.2.1と同様に電気化学的に洗浄した多結晶金ディスク電極を用いて、0.1 – 50 mM QH₂を含 む0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液に浸漬させて、QH₂を金電極に吸着させた。なお、溶液の pHは、低pHの場合は過塩素酸で調整し、pH 7の場合はリン酸二水素カリウム/リン酸水素二 ナトリウム緩衝溶液、pH 9および10の場合はアンモニア/硝酸アンモニウム緩衝溶液、pH 12の 場合は水酸化ナトリウム/リン酸水素ニナトリウム緩衝溶液を用いて、電解質の10分の1の濃度 となるよう加えて調整した。pH 7以上の場合は、空気中の酸素によりQH₂が酸化される可能性 があったことから、窒素を液面上に流して金電極を浸漬させた。金電極はQH₂水溶液から取り 出した後、超純水で洗浄した。Qの場合も同様に行った。実験は全て室温(25±1°C)で行った。

3.2.3 電気化学測定および吸着したヒドロキノンの定量

QH₂およびQ水溶液に浸漬させた金電極を0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液に移し、100 mV s⁻¹においてCV測定を行い、電気二重層の充電容量を引いた酸化ピーク電気量から金電極に 吸着したQH₂の*I*を算出した(Eq. 2-1)。電気化学測定は研究室製三又セルを用いた(Fig. 3-1)。 0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液は10 min間窒素脱気し、測定中は液面上に窒素を流した。



Figure 3-1 Schematic illustration of electrochemical cell.

3.2.4 飛行時間型二次イオン質量分析測定

TOF-SIMS 測定用試料は以下の方法で作製した。2.2.5 と同様のマイカを、スパッタ装置によ り7 mA で5分間エッチングを行った後、10 mA で5分間金をスパッタした(金の膜厚:約100 nm)。作製した金電極を5 mM QH2 あるいは5 mM Q を含む 0.1 M 過塩素酸ナトリウム水溶 液(pH 未調整、pH 5)に 12 h 浸漬させた。その後、電極を溶液から取り出し超純水で洗浄し空 気中で乾燥させた後に、TOF-SIMS 測定を行った。 3.3 結果と考察

3.3.1 ベンゾキノン/ヒドロキノンの電極反応

3.3.1.1 ヒドロキノン水溶液中における電極反応

電気化学的に洗浄した多結晶金電極を5 mMのQH₂を含む0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液 中(pH未調整、pH 5)に浸漬させ、10 min窒素脱気を行った直後の100 mV s⁻¹の第一掃引時 におけるCVをFig. 3-2 curve a、その後の連続した第二掃引時のCVをFig. 3-2 curve blc示す。 なお、QH₂水溶液への浸漬時間が短くかつ電位掃引を行っている状態では、QH₂は金表面に 吸着してもほとんど脱離してしまうため(3.3.2.1.3節)、この条件でCV測定を行った電極は未修 飾電極と呼ぶこととする。第一掃引のCVにおいて、+0.38 V vs. Ag/AgCllこ酸化ピーク、+0.29 および-0.10 VIc還元ピークが出現し、第二掃引では-0.05 VIcも酸化ピークが出現した。 1.4.2節で述べたように、QH₂水溶液中におけるCVでは、2電子2プロトン反応である第一酸化 還元反応(Eq. 1-8)、およびプロトン反応を伴わない第二酸化還元反応(Eq. 1-9)に対応するピ ークが出現する。したがって、+0.38および+0.29 Vの酸化還元ピーク(E°_1 = +0.34 V)は第一 酸化還元反応、-0.05および-0.10 Vの酸化還元ピーク(E°_2 = -0.08 V)は第二酸化還元反応 に対応していると考えられる。

同様にQH₂水溶液中において+0.9 V (酸化)を60 s、-0.5 V (還元)を60 s印加した際の時間 に対する電流応答をFig. 3-3Aに示す。またその結果より得られたコットレルプロット(0.03 – 60 s)をFig. 3-3Bに示す。コットレルプロットがほぼ直線となったことから、拡散が支配的であり、吸 着種の影響はほとんどないことが確認された。直線の傾きは酸化が0.00084、還元が0.00071 となり、傾きからコットレル式(Eq. 3-1)を用いて、QH₂およびQのDを算出したところ、2.4 × 10⁻⁶

$$i(t) = -nFAD^{1/2}C^*\pi^{-1/2}t^{-1/2}$$
(3-1)

および1.7 × 10⁻⁶ cm² s⁻¹となった。溶液中における一般的な分子やイオンのDは10⁻⁵ cm² s⁻¹ のオーダーであるため、これらの値は妥当である。

同様にQH2水溶液中において掃引速度を変えて(5 – 0.005 V s⁻¹)、CV測定を行った(Fig. 3-4A)。その掃引速度に対する酸化還元ピーク電流密度のプロットをFig. 3-4Bに示す。ピーク 電流密度が掃引速度の平方根に比例していることから、この結果からも拡散が支配的であり、 吸着種の影響はほとんどないことが確認された。プロットの傾きからEq. 3-2を用いて、溶液中

$$i_{\rm p} = 2.69 \times 10^5 n^{3/2} A D^{1/2} v^{1/2} C^* \tag{3-2}$$

におけるQH₂およびQのDを算出したところ、 1.2×10^{-6} および 1.0×10^{-6} cm² s⁻¹となった。



Figure 3-2 Cyclic voltammograms of bare gold electrode in 0.1 M NaClO₄ solution containing 5 mM QH₂. Scan rate was 100 mV s⁻¹. (a) First scan and (b) successive second scan.



Figure 3-3 (A) Current response of double potential steps at +0.9 V for 60 s and -0.5 V for 60 s in 0.1 M NaClO₄ solution containing 5 mM QH₂. (B) Cottrell plots for (a) anodic and (b) cathodic reactions in Fig. 3-3A.



Figure 3-4 (A) Cyclic voltammograms of bare gold electrode in 0.1 M NaClO₄ solution containing 5 mM QH₂. Scan rate was (a) 5, (b) 2, (c) 1, (d) 0.5, (e) 0.2, (f), 0.1, (g) 0.05, (h) 0.02, (i) 0.01, and (j) 0.005 V s⁻¹. (B) Plots of peak current of (a) anodic and (b) cathodic reactions versus square root of scan rate of cyclic voltammograms in Fig. 3-4A.

3.3.1.2 ベンゾキノン水溶液中における電極反応

未修飾金電極を5 mMのQを含む0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液中に浸漬させ、10 min窒 素脱気を行った直後の100 mV s⁻¹におけるCVをFig. 3-5 curve alに示す。また比較として同条 件におけるQH₂水溶液中のCV (Fig. 3-2 curve a)をFig. 3-5 curve bとして示す。Q水溶液中の CVにおいて、-0.16 Vに還元ピーク、-0.06 Vに酸化ピークが出現した。1.4.2節および3.3.1.1 節で述べたように、これらの酸化還元ピークはプロトン移動を伴わない2電子の第二酸化還元 反応(Eq. 1-9)に対応していると考えている。第一酸化還元反応に対応するピークが出現しない 理由として、Qが還元される際、pH 5 (pH未調整)では第一還元反応が進行するが、電極近傍 のプロトンがすぐに消費されてしまいプロトン濃度が低くなるため、第二の還元反応が進行し易 くなることが考えられる。なお、同じpH 5においてQH₂水溶液中では第一酸化還元反応に対応 するピークが現れているが(Figure 3-5 curve b)、これはQH₂のQへの酸化時に生じたH⁺が電 極近傍に多く存在するためと考えられる。



Figure 3-5 Cyclic voltammograms of bare gold electrode in 0.1 M NaClO₄ solution containing (a) 5 mM Q and (b) 5 mM QH₂. Scan rate was 100 mV s⁻¹.

3.3.2.1 pH未調整

3.3.2.1.1 速度論的評価

50 mM QH₂を含む0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液(pH未調整、pH 5)に24 h浸漬させた多結晶金電極の0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液(pH 5)中におけるCVをFig. 3-6に示す。+0.35 Vに酸化ピーク、+0.28 Vに還元ピークが出現した。これらから求めた E° ? (+0.32 V)は、拡散種のQ/QH₂の値(+0.34 V) (Fig. 3-2 curve a)とほぼ一致した。したがって、Fig. 3-6における+0.35 Vの酸化ピークは金表面に吸着したQH₂のQへの酸化反応、+0.28 Vの還元ピークは生成したQのQH₂への還元反応に対応していると考えられる。そこで、+0.35 Vの酸化ピークの電気量から金表面に吸着したQH₂の*I*を算出したところ、1.7 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²となった。この値から、吸着したQH₂は単分子膜を形成していると考えられる⁵⁰。

0.1 – 50 mMのQH₂水溶液(pH 5)へ浸漬させた多結晶金電極の、浸漬時間に対するΓ_iのプロ ットをFig. 3-7に示す。プロットに多少ばらつきがあるが、この原因として多結晶金電極であるた め表面状態が測定毎に異なることや、吸着力が強くない(3.3.2.1.2節で述べる)ことが考えられ る。しかし、検討した全ての濃度において、Γ_iは浸漬時間に対して増加した。図中の曲線は、Γ_e および*k*_fを未知パラメータとして、Langmuir吸着律速モデル(Eq. 2-29)へ最小二乗法を用いて フィッティングしたものである。検討した全ての濃度においてプロットと曲線はほぼ一致した。

そこでLangmuir吸着律速モデルへのフィッティングにより Γ_e および k_f を求めた(Table 3-1)。 Γ_e の値は溶液濃度が高くなるほど高くなった。Langmuir吸着律速モデルでは、系が吸着平衡に達してから十分な時間が経過したあと、電極近傍の溶液濃度はバルクの溶液濃度に達するため、 Γ_e はQH₂の溶液濃度に依存する⁶⁶。これらのことから、今回の系において、Eq. 2-4の平衡式がQH₂の吸着平衡を示し、吸着の速度論は吸着律速モデルによって表される可能性が示された。

溶液濃度が高くなると k_f は低くなる傾向を示した $(0.3 - 0.0004 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1})$ 。吸着が速く、強い場合の k_f は $10^3 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ オーダーである^{66,73}。例えばフェロセニルデンドリマーの k_f は $10^3 - 10^4 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ であることが報告されている⁷³。これらの値と比較して今回得られた k_f は非常に小さかったことから、QH₂の多結晶金電極への吸着は遅いと考えているが、全ての溶液濃度において Γ_i は吸着が平衡に達するまで増加し続けた。

吸着が強く、その速度が速い場合には拡散律速となり、 Γ_{l}/Γ_{s} はEq. 2-31で表される⁷⁰。QH₂ の多結晶金電極への吸着過程が拡散律速であると仮定し、 Γ_{l}/Γ_{s} を時間の平方根に対してプロ ットした(Fig. 3-8)。時間の平方根に対して Γ_{l}/Γ_{s} は直線的に増加したことから、拡散律速モデル が適応できる可能性も示された。傾きからEq. 2-31を用いてDを算出したところ、3.5 × 10^{-17} – 9.9 × 10^{-13} cm² s⁻¹となった(Table 3-2)。水溶液中における分子やイオンの一般的なDは 10^{-5} cm² s⁻¹であり、得られたDの値は非常に小さかったことから非物理的であると考えられる。した がって、今回の系において拡散律速モデルは適応できないことが示唆された。

以上の結果から、QH₂の多結晶金電極への吸着に対する速度論は、吸着律速であることが示された。



Figure 3-6 Typical cyclic voltammogram of polycrystalline gold electrode, which was immersed in 50 mM QH₂ solution (pH 5) for 24 h, in 0.1 M NaClO₄ solution. Scan rate was 100 mV s⁻¹.



Figure 3-7 Adsorption kinetics at (A) 0.1, (B) 1, (C) 5, (D) 10, (E) 20, and (F) 50 mM QH₂ on polycrystalline gold electrode in 0.1 M NaClO₄ aqueous solution (pH 5).

 <i>C</i> _A (mM)	$\Gamma_{\rm e}~(10^{-10}{\rm mol~cm^{-2}})$	$k_{\rm f} ({\rm M}^{-1}~{\rm s}^{-1})$
 0.1	0.4	0.3
1	0.4	0.05
5	0.7	0.008
10	1.1	0.002
20	1.5	0.001
50	1.7	0.0004

Table 3-1 Thermodynamic and kinetic parameters for QH₂ from the analysis of Fig. 3-7.



Figure 3-8 Variation of normalized surface coverage as a function of $t^{1/2}$ at (A) 0.1, (B) 1, (C) 5, (D) 10, (E) 20, and (F) 50 mM QH₂ solution (pH 5).

C _A (mM)	slope (10 ⁻³ s ^{-1/2})	$D (\rm cm^2 \ s^{-1})$
0.1	0.6	9.9 × 10 ⁻¹³
1	0.8	1.8 × 10 ⁻¹⁴
5	1.5	2.2 × 10 ⁻¹⁵
10	1.1	3.0 × 10 ⁻¹⁶
20	2.3	3.3 × 10 ⁻¹⁶
50	1.9	3.5 × 10 ⁻¹⁷

Table 3-2 Diffusion coefficients D for QH_2 from the analysis of Fig. 3-8.

3.3.2.1.2 熱力学的評価

速度論的評価(3.3.2.1.1節)においてEq. 2-29を用いて算出した Γ_{e} のQH₂の溶液濃度に対す るプロットをFig. 3-9に示す。Langmuir吸着等温式(Eq. 2-14)あるいはFrumkin吸着等温式(Eq. 2-17)のどちらが本吸着系に適しているかを検討する前に、 Γ_{s} および β の値を求めた。これらの 値を未知パラメータとしてLangmuir吸着等温式(Eq. 2-14)へ最小二乗法を用いてフィッティング を行った結果をFig. 3-9 curve alc示す。得られた値は、 Γ_{s} は1.8 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻² (幾何学的 面積を用いた場合: 3.5 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²)、 β は175 L mol⁻¹となった。

Hubbardらは、多結晶白金電極に吸着したQH₂は水平配列あるいは垂直配列を形成することを報告している⁵⁰⁻⁵²。そこでは0.1 mM以下のQH₂の溶液濃度では、QH₂の芳香環は電極表面に対して水平な向きで吸着し、その際の Γ は3.2 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²であった。QH₂が水平に吸着した場合のσは、共有結合およびファンデルワールス半径を考慮すると53.8 Å²となり、密に吸着した際の Γ の理論値は3.1 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²と算出されている。1 mM以上のQH₂の溶液濃度では、QH₂の芳香環は電極表面に対して垂直な向きで吸着し、その際の Γ は6.0 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²であった。垂直に吸着した場合のσは、28.6 Å²となり、密に吸着した際の Γ の理論値は5.8 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²と算出されている。

上記のように、今回得られた Γ_s の値は、実際の電極面積を用いると1.8 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²となった。QH₂が多結晶金電極に対して水平に配列していると仮定すると、この値は密に吸着した際の Γ (3.1 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²)の約60 %となる。これは、電極表面のラフネスを考慮することによって説明することができる。実際の電極面積は0.041±0.015 cm²であり、幾何学的面積(0.020 cm²)からR_fは2.0と算出され、ラフネスは中程度である。QH₂分子の長さは約6 Åであり、金原子間距離(3 Å)よりも大きい。また上述したようにQH₂のσは53.8 Å²であり、これは金(111)面上に存在する金原子6個分に相当する。さらに、幾何学的電極面積を用いた場合の Γ_s は3.5 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²であり、白金電極に水平配列を形成して密に吸着した際の Γ の理論値とほぼ一致している。したがって、吸着しているQH₂のほとんどは多結晶金電極の凹凸を跨ぐ様に水平配列を形成して吸着しており、密に単分子膜を形成していると考えられる。

吸着質問の相互作用を考慮したFrumkin吸着等温式(Eq. 2-17)が本系に適応できるか検討 した。gを未知パラメータとしてEq. 2-17を用いてフィッティングを行った(Fig. 3-9 curve b)。 Γ_s お よび β の値はLangmuir吸着等温式にフィッティングして得られた値を用いた。gは0.01となり、吸 着したQH₂分子間に弱い引力が働いていることが示された。この引力の原因としてQH₂間の水 素結合や π - π 相互作用が考えられる。しかし、gの値は無視できるほど小さい⁷³。したがって、 QH₂の多結晶金電極への吸着はLangmuir型であることが示された。水素結合が引力に寄与し ていると考えた場合、QH2をQへ酸化することによりこの引力は減少すると考えられる。しかし、 QH2を酸化させると脱離するため(3.3.2.1.3節参照)、詳細を検討することは困難である。また、 π-π相互作用が引力に起因していると考えた場合、QH2の配列が重要となる。しかし、上述した ようにQH2は金表面に対して水平に吸着しているため、この相互作用は小さいと予想される。

Langmuir吸着等温式で算出した β からEq. 2-16を用いて Δ G°を計算したところ、-23 kJ mol⁻¹ となった。 Δ G°の値は3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒドと4-アミノピリジン誘導体が白金へ吸着 した際の Δ G°の値(-22 kJ mol⁻¹)とほぼ一致した⁷⁴。したがって、QH₂は吸着基を有していない が、中程度の吸着力を持つことが示された。QH₂は、酸化電位を印加し表面を活性化させた金 電極に吸着し、それはQH₂の π 電子と金との相互作用によるものであると報告されている⁶⁰。し たがって、本論文のQH₂の多結晶金電極への吸着も、QH₂の π 電子により吸着している可能性 が考えられる。他の可能性として、QH₂のヒドロキシ基と金表面の酸化物とが相互作用して吸 着することも考えている。この相互作用が働いているとすると、QH₂および金表面の酸化物の プロトン化状態が吸着に影響を及ぼす可能性が高い。そこで、3.3.2.2節ではQH₂の吸着への pHの影響を検討した。



Figure 3-9 (a) Langmuir and (b) Frumkin isotherms fitted to the experimental points for QH₂ adsorbed on polycrystalline gold electrode immersed in 0.1 M NaClO₄ solution containing QH₂.

3.3.2.1.3 脱離条件

50 mM QH₂を含む0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液に24 h浸漬させた金電極の、0.1 M過塩 素酸ナトリウム水溶液中におけるCV測定において、連続20掃引した結果をFig. 3-10Aに示す。 このときの、掃引回数に対するQH₂のГのプロットをFig. 3-10Bに示す。電位掃引を繰り返すと、 「は指数関数的に減少し、1サイクル掃引する毎に約30 %減少した。この原因として、電位掃引 を繰り返すと脱離する、あるいは電気化学的活性が低下する等が考えられた。

そこで吸着しているQH₂が脱離する電位を検討した。QH₂が吸着した金電極を用いて、0.1 M 過塩素酸ナトリウム水溶液において0、+0.2、+0.25、+0.3、+0.4、+0.6 Vの定電位を10 min印 加し、その前後のCVからQH₂の*I*を比較した。代表例として5 mM QH₂を含む0.1 M過塩素酸 ナトリウム水溶液に9 h浸漬させた金電極の、0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液中における第一 掃引時のCVをFig. 3-11 curve a、その後+0.2 Vを10 min印加した後のCVをcurve b、さらにそ の後+0.6 Vを10 min印加した後のCVをcurve clニ示す。0および+0.2 Vの定電位を印加した後 のCVでは、酸化ピーク電気量は約20 %減少したが、酸化ピークが出現したことから、電位印 加した後もQH₂は吸着していることが示された。酸化ピーク電気量が約20 %減少したのは、上 述したように電位掃引を繰り返したためと考えられる。一方、+0.25 V以上の定電位を印加した 後のCVでは、酸化ピークが出現しなかった。吸着しているQH₂の酸化反応が起こるのは+0.2 Vより高電位である(Fig. 3-11 curve a)。したがって、QH₂の酸化反応が起こる+0.25 V以上を 印加した後のCVで酸化ピークが現れなかったことから、QH₂が酸化されてQになると脱離する ものと考えられた。脱離の原因として、酸化反応に伴う分子構造の変化や、Qと金との相互作 用が弱いことが考えられる。

Qの吸着およびQH2の再吸着について検討した。5 mM QH2を含む0.1 M過塩素酸ナトリウム 水溶液に浸漬させた金電極を用いて、電解質のみを含む水溶液中で酸化掃引し、吸着してい るQH2を酸化させた後、電極を溶液から取り出し、新しい電解質水溶液に入れてCV測定を行っ たところ、酸化ピークは出現しなかった(Fig. 3-12A)。これに対し、同じ溶液中において連続して 掃引を行うと、2掃引目のパは1掃引目の約70 %となった(Fig. 3-12B)。また、1掃引した後、窒 素ガスでバブリングを1 h行って対流を起こし、その後にCV測定を行うとパは40 %と小さくなった が、吸着していることは確認された(Fig. 3-12C)。したがって、酸化掃引時にQH2は酸化されて Qになると脱離し、Qは電極に吸着しないが、再び還元されてQH2になると再吸着すると考えら れる。また連続掃引した場合に再吸着率が70 %なのは、生成したQが再び還元される前に電 極からバルク溶液領域へ拡散するためと考えられる。

そこでQH2の再吸着とQの拡散について検討した。QH2が吸着した金電極を用いて、電解質

水溶液中で酸化掃引(-0.4~+0.7 V)した後、自然電位で0、20、60、300 s間放置し、その後還 元掃引(+0.7~-0.4 V)を行った。代表例として、自然電位で300 s間放置した場合のCVをFig. 3-12Dに示す。Figure 3-12Eに自然電位での放置した時間と再吸着率との関係を示す。時間 経過に伴い、再吸着率は緩やかに減少した。ここで、濃度勾配がない場合の拡散は、Eq. 3-3

$$x = \sqrt{4Dt} \tag{3-3}$$

x:時間 t 内で粒子が動く平均距離

で示される。QH₂水溶液中において酸化電位を印加した後の還元電位印加時のコットレルプロ ットから算出したQのDは1.7 × 10⁻⁶ cm² s⁻¹であった(3.3.1.1節)。この値を用い、0.1 Mの溶液 中において電極から物質に電子が移動できる距離に対応する10 ÅをQが移動する時間を見積 もったところ、1.5 × 10⁻¹¹ sであった。今回の生成したQの電極からバルク領域への拡散に要す る時間は、濃度勾配がない場合でのタイムスケールと比べてもかなり遅かった。その原因とし て、電極と吸着するほど強くはないが、電極とQ間、あるいはQ同士に相互作用が働いている 可能性が考えられる。

以上の結果から、吸着しているQH₂を酸化させQにすると脱離し、再びQH₂へ還元すると再吸着することが示された。生成したQは電極に吸着はしないが、電極とQ間、あるいはQ同士の相互作用により電極近傍に留まるため、バルク領域への拡散は遅いと考えられた。


Figure 3-10 (A) Typical cyclic voltammograms of polycrystalline gold electrode, which was immersed in 50 mM QH₂ solution (pH 5) for 24 h, in 0.1 M NaClO₄ solution. Scan rate was 100 mV s⁻¹. (a) 1st, (b) successive 2 – 19th, and (c) 20th sweeps. (B) Plots of surface coverage of adsorbed QH₂ on the polycrystalline gold electrode versus cycle number of cyclic voltammogram in Fig. 3-10A.



Figure 3-11 Cyclic voltammograms of polycrystalline gold electrode, which was immersed in 0.1 M NaClO₄ solution containing 5 mM QH₂ for 9 h, in 0.1 M NaClO₄ solution at scan rate of 100 mV s⁻¹. (a) Before and after application of (b) +0.2 V and (c) +0.6 V for 10 min in the NaClO₄ solution.







D

С





Figure 3-12 (A) – (D) Cyclic voltammograms and linear sweep voltammograms of polycrystalline gold electrode, which was immersed in 0.1 M NaClO₄ solution containing 5 mM QH₂, in 0.1 M NaClO₄ solution at scan rate of 100 mV s⁻¹. (A) (a) before and (b) after transferring the electrode to new electrolyte solution, (B) (a) 1st and (b) successive 2nd sweep, (C) (a) before and (b) after bubbling the solution with N₂ gas for 60 min, (D) (a) 1st anodic sweep, (b) cathodic sweep after 300 s of (a) applied rest potential, and (c) cyclic voltammogram after (b). (E) Dependencies of readsorption ratio on rest time after anodic sweep shown in Fig. 3-12D.

3.3.2.2 pHの影響

Figure 3-13にQH₂水溶液のpHに対する金表面に吸着したQH₂の Γ のプロットを示す。なお、 この Γ は多結晶金電極を5 mM QH₂を含む0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液に15 h浸漬させた 場合の値である。また、pHはQH₂水溶液に電極を浸漬させた後の値である。 Γ は同じ条件の測 定でも多少ばらつきがあるが、pH 4 – 10では約0.5 – 1.0 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²となり、QH₂が金に 吸着していることが示された。一方、pH 1 – 3.5では Γ は低く、QH₂はほとんど吸着しないことが 明らかとなった。

QH2の一段階目のpKaは9.85であることから⁴³、検討したpH範囲におけるQH2のプロトン化状態は吸着にほとんど関係ないと考えられる。金表面には酸化物が存在しており、pHに対して金表面のゼータ電位や二重層容量、開回路電位が変化することが報告されている^{75,76}。溶液のpHを高くするとこれらの値は約pH 5で減少し、この原因として金表面のヒドロキシ基のプロトン化状態が変化することが考えられている。Equation 3-4は金表面のヒドロキシ基の水溶液中に

$$Au - OH_2^+ \rightleftharpoons Au - OH + H^+$$
(3-4a)

$$Au - OH \rightleftharpoons Au - O^- + H^+$$
 (3-4b)

おける解離平衡を示す。Equation 3-4aの酸解離定数を K_1 、Eq. 3-4bのものを K_2 とすると、金 表面の二重層容量から算出した K_1 および K_2 の値は両者ともに4.95であった⁷⁶。したがって、pH 4.95以下では金表面のヒドロキシ基は主にプロトン化して正の電荷を有しており、pH 4.95以上 ではヒドロキシ基は脱プロトン化して負の電荷を有していると考えられる。本研究では、pH 1 – 3.5ではQH₂は金表面に吸着せず、pH 4 – 10では吸着した。したがって、金表面のヒドロキシ 基が脱プロトン化し負の電荷を有しているときQH₂は吸着すると考えられる。そのため、金表面 は電子供与性サイトとして働き、QH₂の電子受容性を示す部位と相互作用するものと考えられ る。

ベンゼン環上のヒドロキシ基は共鳴効果を及ぼす電子供与基であることから、QH2のπ軌道 は電子豊富となり、電子供与性を示す。そのため、QH2のπ電子は金表面の電子受容サイトと 互いに軌道を形成して電荷移動錯体を形成すると予想される(Fig. 3-14A)。しかし、今回の結 果では上述したように金表面のヒドロキシ基が脱プロトン化し、電子供与性サイトとして働く場 合に吸着すると考えられる。したがって、今回の吸着は、π軌道の相互作用によるものが主では ないと考えられる。

Spartan Student v5.0.1により計算したQH2分子の各原子における電荷密度をFig. 3-15Aに 示す。また電荷密度から考えられる共鳴構造をFig. 3-15Bに示す。上述したように、ベンゼン環 上のヒドロキシ基は共鳴効果を及ぼす電子供与基であるが、酸素原子の電気陰性度が高いこ とから、ogh格では誘起効果により電子求引性になる。ヒドロキシ基と結合したイプソ位の炭素 は正電荷を有していることから、誘起効果が共鳴効果よりも勝っていると考えられる。すなわち、 QH2分子内において大きく正に帯電している原子は、イプソ位の炭素およびヒドロキシ基の水 素である。したがって、これらは電子受容性を示すことから、金表面上の電子供与性サイトであ る脱プロトン化したヒドロキシ基とこれらの両方あるいは一方が、相互作用して吸着する可能性 が考えられる(Fig. 3-14B, C)。



Figure 3-13 Surface coverage of QH₂ adsorbed on polycrystalline gold electrode as a function of pH.



Figure 3-14 Schematic illustrations of adsorption interactions between hydroxy groups of polycrystalline gold electrode and (A) π electrons, (B) hydrogen of hydroxy group, and (C) carbon at ipso position of QH₂.



Figure 3-15 (A) Charge densities of atoms in QH_2 molecule. (B) Possible resonance structure of QH_2 molecule on the basis of the charge densities in Fig. 3-15A.

3.3.3 ベンゾキノンの多結晶金電極への吸着特性評価

5 mM Qを含む0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液に10 minおよび12 h浸漬させた多結晶金電 極の0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液中におけるCVをFig. 3-16 curves aおよびbに示す。浸 漬時間が10 minの場合は-0.26 V、12 hの場合では-0.28 Vに還元ピークが出現した。これら のピークは、Q水溶液中におけるプロトン移動を伴わない反応(Eq. 1-9)に対応するQの還元ピ ーク電位(-0.16 V)と値が近い(Fig. 3-5)。したがって、Fig. 3-16 curves aおよびbの還元ピーク は、多結晶金表面に吸着したQの、プロトン移動を伴わない還元反応に対応するものと考えら れる。QのIを還元ピークの電気量から算出したところ、Q水溶液への浸漬時間が10 minの場 合では0.2 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²、浸漬時間が12 hの場合では0.3 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²であった。これ らの値はQH₂に比べて半分以下であり、吸着力は低いことが示された。このことは、3.3.2.1.3 で述べた、QH₂を酸化してQにすると脱離することとは矛盾しない。

Figure 3-16 curve bの測定後、Qが還元される-0.4 Vを5 min印加した後のCVをFig. 3-16 curve clc示す。-0.4 Vを5 min印加したことにより、-0.28 Vの還元ピークが消失した。したがって、還元電位を印加すると、吸着していたQが脱離することが示された。脱離する原因として、QH₂が酸化されQになると脱離する場合と同様に、Qが還元されQ²⁻になる過程における摂動によるものと考えている。



Figure 3-16 Cyclic voltammograms in 0.1 M NaClO₄ solution for polycrystalline gold electrodes, which were immersed in 5 mM Q solution for (a) 10 min and (b) 12 h, and (c) after application of -0.4 V for 5 min in 0.1 M NaClO₄ solution after curve b. Scan rate was 100 mV s⁻¹.

3.3.4 飛行時間型二次イオン質量分析法による金電極への吸着の直接評価 3.3.4.1 ヒドロキノン

これまでの吸着特性評価ではCVを用いていたが、CVでは吸着質の種類をピーク電位から間 接的に評価していた。そこで、電極表面に存在する化学種の同定が行えるTOF-SIMS測定に より、QH₂およびQの吸着の直接的な評価を行った。

5 mM QH₂を含む0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液に12 h浸漬させた多結晶金電極の TOF-SIMSスペクトルをFig. 3-17Aに示す。比較として0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液に12 h 浸漬させたもののスペクトルをFig. 3-17Bに示す。QH₂の精密質量数は110.04である。QH₂水 溶液に浸漬させた電極では*m/z* 110.04にピークが出現し、電解質のみを含む水溶液に浸漬さ せた電極では現れなかったことから、QH₂水溶液に浸漬させ超純水で洗浄した金電極の表面 には、QH₂が存在していることが明らかとなった。このことは、QH₂水溶液中においてQH₂が金 表面に吸着することを示す。*m/z* 110.07に大きなピークが出現したが、このピークは電解質水 溶液に浸漬させた電極でも出現したことから(Fig. 3-17B)、電解質由来の物質が電極表面に存 在していることを示している。TOF-SIMS測定では、試料表面の化学状態によって同じ種の二 次イオンであってもそのイオン化率が異なるため、検出された各成分の存在量をそのピーク強 度で単純に比較することは難しい。したがって、現段階では*m/z* 110.07の物質を同定すること は困難である。



Figure 3-17 TOF-SIMS spectra of polycrystalline gold surfaces after immersion in (A) 0.1 M NaClO₄ solution containing 5 mM QH₂ and (B) 0.1 M NaClO₄ solution for 12 h.

3.3.4.2 ベンゾキノン

5 mM Qを含む0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液に12 h浸漬させた多結晶金電極の TOF-SIMSスペクトルをFig. 3-18Aに示す。比較として0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液に12 h 浸漬させたもののスペクトルをFig. 3-18Bに示す。Qの精密質量数は108.02である。Q水溶液 に浸漬させた電極ではm/z 108.02にピークが出現せず、m/z 108.06にピークが出現した。この ピークは電解質水溶液に浸漬させた電極でも出現したことから、電解質由来の物質であると考 えている。Q水溶液に浸漬させた電極においてQのピークが出現しなかった理由として、Qは金 表面に吸着しない、あるいはTOF-SIMS測定中に電極を真空にさらした際にQが脱離してしま った可能性が考えられる。Qが金表面に吸着しないことは、QH₂が吸着した電極のCVにおいて、 QH₂をQに酸化すると脱離する結果と一致している(3.3.2.1.3節)。また、真空中でQが脱離して しまう可能性も、Qが昇華しやすい性質を持つことからも十分に考えられ、今後さらなる検討が 必要である。



Figure 3-18 TOF-SIMS spectra of polycrystalline gold surfaces after immersion in (A) 0.1 M NaClO₄ solution containing 5 mM Q and (B) 0.1 M NaClO₄ solution for 12 h.

3.4 結言

本章では、QH₂およびQの電極反応特性および多結晶金電極上への吸着をCVにより評価し た。pH 5 (pH未調整)のQH2水溶液中におけるCVでは、プロトン移動を伴う第一酸化還元反応 に対応するピークが出現したのに対し、Q水溶液中ではプロトン移動を伴わない第二酸化還元 反応に対応するピークが出現した。QH2の多結晶金電極上への吸着の速度論的評価では、吸 着速度は遅く、吸着律速であることを明らかにした。熱力学的評価では、Frumkin吸着等温式 のgが無視できるほど小さかったことから、QH2の多結晶金電極への吸着はLangmuir型である ことが示された。幾何学的電極面積を用いた場合の $\Gamma_{\rm s}$ は3.5 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²であり、白金電 極に水平配列を形成して密に吸着した際のΓの理論値とほぼ一致した。したがって、吸着して いるQH2のほとんどは多結晶金電極の凹凸を跨ぐ様に水平配列を形成して吸着しており、密に 単分子膜を形成していると考えられた。吸着したQH2の脱離については、吸着しているQH2を 酸化させQにすると脱離し、再びQH2へ還元すると再吸着することが示された。吸着へのpHの 影響について検討したところ、pH 4 - 10ではQH2が金に吸着していたのに対し、pH 1 - 3.5で はほとんど吸着しなかった。金表面には酸化物が存在しており、金表面のヒドロキシ基の酸解 離定数は4.95であることから、それが脱プロトン化し負の電荷を有しているときQHっは吸着する と考えられた。そのため、金表面は電子供与性サイトとして働き、電子受容性を示すQH2分子 内のイプソ位の炭素およびヒドロキシ基の水素と相互作用するものと考えられた。Qの金表面 への吸着特性評価では、QのTはQH2に比べて半分以下であり、吸着力は低いことが示された。 TOF-SIMS測定を行いQH₂およびQの金電極への吸着を直接的に評価したところ、QH₂は金表 面に吸着することが確認された。一方、Qの吸着は確認されなかった。その理由として、Qは金 表面に吸着しない、あるいは真空中でQが脱離してしまった可能性が考えられる。

第4章 金電極へ吸着したヒドロキノンの

溶存種の電気化学特性への影響

4.1 緒言

第3章ではQH₂の多結晶金電極への吸着を速度論的および熱力学的に評価した。本章では 吸着したQH₂が溶存種の電子移動を妨害することを新たに見出した。一般的には同じ化学種 の吸着によりその電子移動が速くなることが報告されているが、自種の電子移動を妨害 する現象は新しい。吸着したQH₂が全体の酸化還元反応に影響を与えている可能性が高い ことから、QH₂の吸着により溶存種の電子移動を制御できる可能性があり、センサ等への 応用も期待される。

そこで、第3章の吸着特性に関する知見に基づき、本章では多結晶金電極へ吸着したQH2の 溶存種の電気化学特性への影響について評価した。QH2が吸着した多結晶金電極を用いて、 水溶液中に存在するQH2、外圏型電子移動を示す酸化還元活性種であるフェリ/フェロシアン 化物イオンおよびへキサアンミンルテニウム(III/II)イオン、内圏型電子移動を示すアスコルビン 酸のCV測定を行い、電子移動速度について検討した。

4.2 実験

4.2.1 試薬および装置

フェロシアン化カリウム(特級、和光純薬)、アスコルビン酸(特級、和光純薬)、硝酸ナトリウム (特級、片山化学工業)はそのまま用いた。硝酸ヘキサアンミンルテニウム(III)は、塩化ヘキサ アンミンルテニウム(III) (Aldrich)を硝酸ナトリウムによりアニオン交換したものを用いた。他の 試薬および装置は、2.2.1および3.2.1と同じものを用いた。

4.2.2 ヒドロキノン吸着電極の作製

3.2.2節と同様に電気化学的に洗浄した多結晶金ディスク電極を5および50 mM QH₂を含む 0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液(pH未調整、pH 5)に12および24 h浸漬させて、QH₂を金電極 に吸着させた。なお、吸着させる条件を2つ検討しているのは、QH₂の吸着量を変化させるため である。

4.2.3 電気化学測定

2.2.2節と同様に、電気化学的に洗浄した多結晶金電極(未修飾金電極)、および4.2.2で作製 したQH₂吸着金電極を用いて、5 mMのQH₂を含む0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液および5 mMのフェロシアン化カリウムを含む0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液、5 mMの硝酸ヘキサア ンミンルテニウム(III)を含む0.1 M硝酸ナトリウム水溶液、5 mMのアスコルビン酸を含む0.1 M 過塩素酸ナトリウム水溶液中において、100 mV s⁻¹でCV測定を行った。それらのCVの酸化と 還元のピーク電位差 ΔE_p および $E_{p,a}$ から、各酸化還元活性種の電極反応における電子移動に ついて評価した。電気化学的測定は3.2.3節と同様に行った。

4.3 結果と考察

4.3.1 ベンゾキノン/ヒドロキノンに対する応答

未修飾金電極および5 mMのQH₂水溶液に12 hあるいは50 mMのQH₂水溶液に24 h浸漬さ せたQH₂吸着金電極を用いて、5 mMのQH₂を含む0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液中(pH 5) において100 mV s⁻¹でCV測定を行った(Fig. 4-1)。未修飾金電極では、3.3.1.1節で述べたよう に、+0.38 Vおよび+0.28 VI:第一酸化還元反応に対応するピークが出現し、 ΔE_p |は0.10 Vであ った(Fig. 4-1 curve a)。一方、QH₂吸着金電極では、5 mMのQH₂水溶液に12 h浸漬させた場 合には+0.41 VI:酸化ピーク、+0.19 VI:還元ピークが出現し、 ΔE_p |は0.22 Vであった(Fig. 4-1 curve b)。50 mMのQH₂水溶液に24 h浸漬させた場合には+0.46 Vおよび+0.70 VI:酸化ピー ク、+0.18 VI:還元ピークが出現し、 ΔE_p |は0.28 Vおよび0.52 Vであった(Fig. 4-1 curve c)。酸 化ピークが2つ出現した理由は不明であるが、*I*が大きくなると、溶液中に存在するQH₂の電子 移動をより妨げるドメインが形成されている可能性などが考えられる。また、5 mMのQH₂水溶 液に12 h浸漬させたQH₂吸着金電極において、QH₂が酸化される+0.9 Vを30 min印加した後 に再度CV測定を行うと、+0.39 VI:酸化ピーク、+0.27 VI:還元ピークが出現し、 ΔE_p |は0.12 V と酸化電位を印加する前よりも小さくなった(Fig. 4-1 curve d)。これらの結果をTable 4-1にまと めた。

*I*は5 mMのQH₂水溶液に12 h浸漬させた場合では約0.7 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²、50 mMのQH₂ 水溶液に24 h浸漬させた場合では約1.5 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²であったことから(3.3.2.1.1節)、金 表面に吸着しているQH₂の*I*が高いほど ΔE_p は大きくなることが示された。また吸着している QH₂を酸化させ脱離させると ΔE_p は未修飾電極の場合とほぼ同じ値まで減少した。したがって、 QH₂が金表面に吸着していると溶液中のQ/QH₂の電子移動を妨害し、さらに吸着しているQH₂ の*I*が高いほどより電子移動は妨害される可能性が示された。なお、電子移動速度を評価する 場合、掃引速度を変えてCV測定を行うべきである。しかし本系では3.3.2.1.3節で述べた様に、 QH₂をQに酸化すると金電極から脱離してしまう。そのため掃引速度を変えたCV測定は行えず、 100 mV s⁻¹のみとした。

上述したように、未修飾金電極のQH₂水溶液中におけるCVの ΔE_p は0.10 Vと小さく、電子移動速度は速い(Fig. 4-1 curve a)。さらに、3.3.2.1.1節で述べたように、吸着したQH₂の電解質のみの水溶液中におけるCVの ΔE_p は0.07 Vと小さく、吸着種の電子移動速度は速かった(Fig. 3-6)。しかし、QH₂が金表面に吸着していると溶液中のQ/QH₂の電子移動は遅くなった。

1.5.3節で述べたように、キノン類は単結晶および多結晶白金⁵⁰⁻⁵⁶、単結晶パラジウム^{57,58}、 炭素電極⁴⁴⁻⁴⁹など、様々な種類の電極に吸着することが報告されている。グラッシーカーボン 電極において、溶存種の電子移動は妨害しないがQH2の電極への吸着を妨げるメチレンブル ーや、ニトロフェニルおよびトリフルオロメチルフェニル基を電極表面に修飾すると、QH2の電子 移動が遅くなる。これらの結果から溶存種の電子移動を速くするにはQH2が電極に吸着するこ とが必要であると考察されている^{46,47}。今回の結果はQH2が電極表面に吸着すると溶存種の 電子移動が遅くなるため、この論文の考察と一致しなかった。

未修飾のグラッシーカーボン電極を用いて同様にQH₂水溶液中でCV測定を行うと、+0.49 V に酸化ピーク、+0.17 VIこ酸化還元ピークが出現し、Δ*E*_pは0.32 Vと大きく電子移動速度が遅い ことが確認された(Fig. 4-2)。グラッシーカーボン電極表面は複雑な構造を形成しており、炭素 のsp²構造や酸素を含む官能基が存在することが報告されている⁷⁷。グラッシーカーボン上で電 子移動が行われるのは、主に炭素のsp²構造のエッジプレーンであるとされている。そのため、 炭素のsp²構造や酸素含有官能基部分では溶液中のQ/QH₂の電子移動速度は遅いと考えて いる。これらのことから、吸着したQH₂が溶液中のQ/QH₂の酸化還元反応における電子移動速 度へ影響を及ぼす考え得るメカニズムを以下に示す。金電極表面に吸着したQH₂とグラッシー カーボンの構造が類似しており、QH₂分子の炭素のsp²構造やヒドロキシ基部分では電子移動 が遅くなる、あるいは吸着種と溶液種の自己電子交換が遅いことも考えられる(Fig. 4-3)。

QからQ²⁻への還元反応に対応する還元ピーク($E_{p,c}$: -0.10 V)は、QH₂の吸着の有無に関わらずほぼ一定であった(Fig. 4-1)。したがって、この還元反応における電子移動はQH₂の吸着の影響を受けないものと考えられる。

Q/QH2の電子移動は、電極の表面状態の影響を受け易い内圏型電子移動である(1.4.2節)。 次節では、電極の表面状態の影響を受けにくいとされている外圏型電子移動への、吸着した QH2の影響について検討した。



Figure 4-1 Cyclic voltammograms in 0.1 M NaClO₄ solutions containing 5 mM QH₂ (pH 5) at scan rate of 100 mV s⁻¹. (a) Bare polycrystalline gold electrode, (b) polycrystalline gold electrode, which was immersed in 0.1 M NaClO₄ solutions (pH 5) containing 5 mM QH₂ for 12 h, and (c) electrode which was immersed in 0.1 M NaClO₄ solutions (pH 5) containing 50 mM QH₂ for 24 h. (d) After application of +0.9 V for 30 min to polycrystalline gold electrode, which was immersed in 0.1 M NaClO₄ solutions (pH 5) containing 5 mM QH₂ for 12 h.

Table 4-1 Anodic and cathodic peak potentials, peak separation, and formal potential of cyclic voltammograms in Fig. 4-1, and surface coverage of adsorbed QH₂ on polycrystalline gold electrode shown in Fig. 3-7.

Electrode	$E_{p,a}$	$E_{\rm p,c}$	ΔE_{p}	E°'	Г
	(V)	(V)	(V)	(V)	(mol cm ⁻²)
Bare	+0.38	+0.28	0.10	+0.33	-
Immersed in 5 mM QH_2 solution for 12 h	+0.41	+0.19	0.22	+0.30	0.7×10^{-10}
Immersed in 50 mM QH_2 solution for 24 h	+0.46	+0.18	0.28	+0.32	1.5 × 10 ⁻¹⁰
	+0.70		0.52	+0.44	
After application of +0.9 V for 30 min	10.20	+0.27	0.12	+0.33	-
(immersed in 5 mM QH_2 solution for 12 h)	+0.39				



Figure 4-2 Cyclic voltammogram of glassy carbon electrode in 0.1 M NaClO₄ solution containing 5 mM QH₂ (pH 5) at scan rate of 100 mV s⁻¹.



Figure 4-3 Schematic illustration of the proposed redox reaction mechanism of Q/QH₂ at polycrystalline gold electrode on which QH₂ adsorbed at (A) low surface coverage and (B) high surface coverage (see text for details).

4.3.2 外圏型電子移動を伴う酸化還元活性種に対する応答

未修飾金電極および5 mMのQH₂水溶液に12 hあるいは50 mMのQH₂水溶液に24 h浸漬さ せたQH₂吸着金電極を用いて、5 mMのフェロシアン化カリウムを含む0. 1 M過塩素酸ナトリウ ム水溶液および5 mMの硝酸ヘキサアンミンルテニウム(III)を含む0.1 M硝酸ナトリウム水溶液 中において100 mV s⁻¹でCV測定を行った(Figs. 4-4および4-5)。またそれらの ΔE_p 、 E° 'をそれ ぞれTable 4-2および4-3にまとめた。

フェロシアン化カリウム水溶液中において、未修飾金電極では+0.26 Vに酸化ピーク、+0.17 Vに還元ピークが出現し、 ΔE_p は0.09 Vであった(Fig. 4-4 curve a)。QH₂吸着金電極では、5 mMのQH₂水溶液に12 h浸漬させた場合および50 mMのQH₂水溶液に24 h浸漬させた場合と もに、+0.26 Vに酸化ピーク、+0.16 Vに還元ピークが出現し、 ΔE_p は0.10 Vであった(Fig. 4-4 curves bおよびc)。したがって、フェリ/フェロシアン化物イオンの電子移動速度は、QH₂を金表 面に吸着させてもほとんど変化しなかった。

硝酸ヘキサアンミンルテニウム(III)水溶液中における未修飾金電極のCVでは、-0.16 Vに還 元ピーク、-0.09 Vに酸化ピークが出現し、 ΔE_p は0.07 Vであった(Fig. 4-5 curve a)。QH₂吸着 金電極では、5 mMのQH₂水溶液に12 h浸漬させた場合および50 mMのQH₂水溶液に24 h浸 漬させた場合ともに、-0.17 Vに還元ピーク、-0.09 Vに酸化ピークが出現し、 ΔE_p は0.08 Vであ った(Fig. 4-5 curves bおよびc)。したがって、ヘキサアンミンルテニウム(III/II)イオンの電子移 動速度も、QH₂を金表面に吸着させてもほとんど変化しないことが示された。

以上より、外圏型反応であるフェリ/フェロシアン化物イオンおよびヘキサアンミンルテニウム (III/II)イオンの電子移動速度は、QH2の吸着の有無に依存しないと考えられた。



Figure 4-4 Cyclic voltammograms in 0.1 M NaClO₄ solution containing 5 mM K₄[Fe(CN)₆] (pH 5) at scan rate of 100 mV s⁻¹. (a) Bare polycrystalline gold electrode, (b) polycrystalline gold electrode, which was immersed in 0.1 M NaClO₄ solutions (pH 5) containing 5 mM QH₂ for 12 h, and (c) electrode which was immersed in 0.1 M NaClO₄ solutions (pH 5) containing 50 mM QH₂ for 24 h.

Table 4-2 Anodic and cathodic peak potentials, peak separation, and formal potential of cyclic voltammograms in Fig. 4-4, and surface coverage of adsorbed QH₂ on polycrystalline gold electrode shown in Fig. 3-7.

Electrode	$E_{p,a}$	$E_{\rm p,c}$	ΔE_{p}	E°'	Г
	(V)	(V)	(V)	(V)	(mol cm ⁻²)
Bare	+0.26	+0.17	0.09	+0.22	_
Immersed in 5 mM QH_2 solution for 12 h	+0.26	+0.16	0.10	+0.21	0.7 × 10 ⁻¹⁰
Immersed in 50 mM QH_2 solution for 24 h	+0.26	+0.16	0.10	+0.21	1.5 × 10 ⁻¹⁰



Figure 4-5 Cyclic voltammograms in 0.1 M NaNO₃ solution containing 5 mM $[Ru(NH_3)_6](NO_3)_3$ at scan rate of 100 mV s⁻¹. (a) Bare polycrystalline gold electrode, (b) polycrystalline gold electrode which was immersed in 0.1 M NaClO₄ solutions (pH 5) containing 5 mM QH₂ for 12 h, and (c) electrode which was immersed in 0.1 M NaClO₄ solutions (pH 5) containing 50 mM QH₂ for 24 h.

Table 4-3 Anodic and cathodic peak potentials, peak separation, and formal potential of cyclic voltammograms in Fig. 4-5, and surface coverage of adsorbed QH₂ on a polycrystalline gold electrode shown in Fig. 3-7.

Electrode	$E_{p,a}$	$E_{\rm p,c}$	ΔE_{p}	E°'	Г
	(V)	(V)	(V)	(V)	(mol cm ⁻²)
Bare	-0.09	-0.16	0.07	-0.12	_
Immersed in 5 mM QH_2 solution for 12 h	-0.09	-0.17	0.08	-0.13	0.7 × 10 ⁻¹⁰
Immersed in 50 mM QH_2 solution for 24 h	-0.09	-0.17	0.08	0.13	1.5 × 10 ⁻¹⁰

4.3.3 内圏型電子移動を伴う酸化還元活性種に対する応答

金電極に吸着したQH₂は、外圏型反応を示す酸化還元活性種の電子移動速度へは影響を 与えなかった。そこで本節では、内圏型反応を示す系への影響を検討した。未修飾金電極およ び5 mMのQH₂水溶液に12 hあるいは50 mMのQH₂水溶液に24 h浸漬させたQH₂吸着金電極 を用いて、5 mMアスコルビン酸を含む0.1 M過塩素酸ナトリウム水溶液中において100 mV s⁻¹ でCV測定を行った(Fig. 4-6)。第一掃引時(Fig. 4-6 curve a)、およびQH₂が酸化される+0.8 V を30分間印加し、QH₂が脱離した後のCV (Fig. 4-6 curve b)を比較した。+0.8 V印加の前後に おける $E_{p,a}$ とそのシフト量(以後 $\Delta E_{p,a}$ と表記)をTable 4-4に示す。未修飾金電極では $\Delta E_{p,a}$ は-0.006 Vであった(Fig. 4-6A)。5 mM QH₂水溶液に12 h浸漬させた電極(Γ :約0.7 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²)の $\Delta E_{p,a}$ は-0.015 V (Fig. 4-6B)、50 mM QH₂水溶液に24 h浸漬させた電極(Γ :約1.5 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²)は-0.028 V (Fig. 4-6C)であった。QH₂吸着金電極の $\Delta E_{p,a}$ は未修飾金電極よ りも大きく、またQH₂の Γ が高いほど $\Delta E_{p,a}$ がより大きくなったことから、内圏型反応であるアスコ ルビン酸の電子移動を、吸着したQH₂が妨害したと考えられる。





А





Figure 4-6 Cyclic voltammograms in 0.1 M NaClO₄ solution containing 5 mM ascorbic acid at scan rate of 100 mV s⁻¹. (A) Bare polycrystalline gold electrode, (B) polycrystalline gold electrode which was immersed in 0.1 M NaClO₄ solutions (pH 5) containing 5 mM QH₂ for 12 h, and (C) electrode which was immersed in 0.1 M NaClO₄ solutions (pH 5) containing 50 mM QH₂ for 24 h. (a) Before and (b) after application of +0.8 V for 30 min to the electorde.

Table 4-4 Anodic peak potentials of cyclic voltammograms before and after application of +0.8 V for 30 min in Fig. 4-6 and surface coverage of adsorbed QH₂ on a polycrystalline gold electrode shown in Fig. 3-7.

Electrode	$E_{p,a}$	а (V)	$\Delta E_{p,a}$	Г
	Before	After	(V)	(mol cm ⁻²)
Bare	+0.297	+0.291	-0.006	_
Immersed in 5 mM QH_2 solution for 12 h	+0.303	+0.288	-0.015	0.7 × 10 ⁻¹⁰
Immersed in 50 mM QH_2 solution for 24 h	+0.310	+0.282	-0.028	1.5 × 10 ⁻¹⁰

4.4 結言

金電極へ吸着したQH₂の溶存種の電気化学特性への影響について評価した。QH₂水溶液中 におけるCVでは、未修飾金電極では ΔE_p は0.10 Vであったのに対し、QH₂吸着金電極では、5 mMのQH₂水溶液に12 h浸漬させた場合には ΔE_p は0.22 V、50 mMのQH₂水溶液に24 h浸漬 させた場合には ΔE_p は0.28および0.52 Vであった。したがって、QH₂の Γ が高いほど電子移動 速度は遅くなると考えられた。その原因として、金電極表面に吸着したQH₂とグラッシーカーボ ンの構造が類似しており、QH₂分子の炭素のsp²構造やヒドロキシ基部分では電子移動が遅く なる、あるいは吸着種と溶液種の自己電子交換が遅いことも考えられた。フェロシアン化カリウ ムおよび硝酸へキサアンミンルテニウム(III)水溶液中におけるCVでは、QH₂の吸着により ΔE_p は変化しなかった。したがって、外圏型反応であるこれらの電子移動速度は、QH₂の吸着の有 無に依存しないと考えられた。アスコルビン酸水溶液中におけるCVでは、QH₂が酸化される電 位を印加しQH₂が脱離する前後における $E_{p,a}$ を比較したところ、QH₂の Γ が高いほど $\Delta E_{p,a}$ が大 きくなった。したがって、内圏型反応であるアスコルビン酸の電子移動を、吸着したQH₂が妨害 することが示された。このように、金表面に吸着したQH₂により、内圏型の溶存種の電子移動速 度を制御できる可能性が示された。

第5章 結論

本研究では、AETの多結晶金電極への速度論的および熱力学的吸着特性を電気化学的に 評価し、吸着の包括的な知見を得た。また吸着基を持たないQH2が多結晶金上に吸着すること を見出し、その速度論的および熱力学的評価を行った。さらに吸着したQH2の溶存種の電気化 学特性への影響について評価した。

第1章「序論」では、吸着現象、アルキルチオールの自己組織化単分子膜、キノン類の特徴や 応用などの研究背景を述べ、本研究の意義と目的を明らかにした。

第2章「アミノエタンチオールの多結晶金電極への吸着特性評価」では、AETの多結晶金電極 上への吸着をCVによる還元脱離法を用いて評価した。CVでは1サイクル目に-0.63、-0.80お よび-1.0 Vに還元ピークが出現し、それぞれ金(111)、(100)、(110)面に吸着したAETの還元 脱離反応に対応することを明らかにした。このことから、多結晶上の金(111)、(100)、(110)面に 吸着したAET単分子膜の安定性は、(111)、(100)、(110)の順に高くなることも見出した。吸着 の速度論的評価では、AET溶液が3および4 μ Mの場合では、拡散律速モデルへよく一致し、さ らにそのモデルおよびPFG-NMR測定から求めたDがほぼ一致したことから拡散律速と考えら れた。5 - 100 μ Mの場合では実験値とLangmuir吸着律速モデルがほぼ一致したことから、吸 着律速と考えられた。熱力学的評価では、Frumkin吸着等温式のgが無視できるほど小さかっ たことから、AETの多結晶金電極への吸着はLangmuir型であることが示された。 Γ_s は5.2 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²となりAETが単結晶金(111)表面に密に吸着した際の Γ (6.6 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²) よりも小さかったことから、AETは多結晶金表面に寝た形で吸着している、あるいはAETは金 の結晶面により吸着の配列が異なり、 Γ が結晶面に依存することが考えられた。

第3章「ヒドロキノンの多結晶金電極への吸着特性評価」では、QH₂およびQの電極反応特性 および多結晶金電極上への吸着をCVにより評価した。pH 5 (pH未調整)のQH₂水溶液中にお けるCVでは、プロトン移動を伴う第一酸化還元反応に対応するピークが出現したのに対し、Q 水溶液中ではプロトン移動を伴わない第二酸化還元反応に対応するピークが出現した。QH₂ の多結晶金電極上への吸着の速度論的評価では、吸着速度は遅く、吸着律速であることを明 らかにした。熱力学的評価では、Frumkin吸着等温式のgが無視できるほど小さかったことから、 QH₂の多結晶金電極への吸着はLangmuir型であることが示された。幾何学的電極面積を用 いた場合の Γ_{s} は3.5 × 10⁻¹⁰ mol cm⁻²であり、白金電極に水平配列を形成して密に吸着した際 の Γ の理論値とほぼ一致した。したがって、吸着しているQH₂のほとんどは多結晶金電極の凹 凸を跨ぐ様に水平配列を形成して吸着しており、密に単分子膜を形成していると考えられた。 吸着したQH2の脱離については、QH2を酸化させQにすると脱離し、再びQH2へ還元すると再 吸着することが示された。吸着へのpHの影響について検討したところ、pH 4 – 10ではQH2が 金に吸着していたのに対し、pH 1 – 3.5ではほとんど吸着しなかった。金表面には酸化物が存 在しており、金表面のヒドロキシ基の酸解離定数は4.95であることから、金表面のヒドロキシ基 が脱プロトン化し負の電荷を有しているときQH2は吸着すると考えられた。そのため、金表面は 電子供与性サイトとして働き、電子受容性を示すQH2分子内のイプソ位の炭素およびヒドロキ シ基の水素が相互作用するものと考えられた。Qの金表面への吸着特性評価では、Qの*I*は QH2に比べて半分以下であり、吸着力は低いことが示された。TOF-SIMS測定を行いQH2およ びQの金電極への吸着を直接的に評価したところ、QH2は金表面に吸着することが確認された。 ー方、Qの吸着は確認されなかった。その理由として、Qは金表面に吸着しない、あるいは真空 中でQが脱離した可能性が考えられた。

第4章「金電極へ吸着したヒドロキノンの溶存種の電気化学特性への影響」では、金電極へ吸 着したQH₂の溶存種の電気化学特性への影響について評価した。QH₂水溶液中におけるCV では、未修飾金電極では ΔE_p は0.10 Vであったのに対し、QH₂吸着金電極では、5 mMのQH₂ 水溶液に12 h浸漬させた場合には ΔE_p は0.22 V、50 mMのQH₂水溶液に24 h浸漬させた場合 には ΔE_p は0.28および0.52 Vであった。したがって、QH₂の*I*が高いほど電子移動速度は遅くな ると考えられた。その原因として、金電極表面に吸着したQH₂とグラッシーカーボンの構造が類 似しており、QH₂分子の炭素のsp²構造やヒドロキシ基部分では電子移動が遅くなる、あるいは 吸着種と溶液種の自己電子交換が遅いことも考えられた。フェロシアン化カリウムおよび硝酸 ヘキサアンミンルテニウム(III)水溶液中におけるCVでは、QH₂の吸着により ΔE_p は変化しなか った。したがって、外圏型反応であるこれらの電子移動速度は、QH₂の吸着の有無に依存しな いと考えられた。アスコルビン酸水溶液中におけるCVでは、QH₂が酸化される電位を印加し QH₂が脱離する前後における $E_{p,a}$ を比較したところ、QH₂の*I*が高いほど $\Delta E_{p,a}$ が大きくなった。 したがって、内圏型反応であるアスコルビン酸の電子移動を、吸着したQH₂が妨害することが 示された。このように、金表面に吸着したQH₂により内圏型の溶存種の電子移動速度を制御で きる可能性が示された。

以上のように、本研究では、これまでに報告例のないAETの多結晶金電極への吸着の速度 論的および熱力学的特性を電気化学的に評価した。AETは多結晶金表面に寝た形で吸着して いる、あるいはAETは金の結晶面により吸着の配列が異なり、「が結晶面に依存することが考 えられた。得られた結果は、広く用いられているAETをアンカーなどとして応用する際の重要な 知見となる。また、AETだけでなく、炭素鎖数の短い他のアルキルチオールSAMの吸着特性の 基礎的な知見となると期待できる。今後、単結晶金電極上へのAETの吸着特性を評価すること により、結晶面の違いによる吸着特性の違いを明らかにすることで、より包括的な知見が得ら れるものと期待される。

QH₂の多結晶金電極への吸着の速度論的および熱力学的特性を電気化学的に評価した。 吸着基を持たないQH₂の吸着特性を評価できたことから、他の小分子吸着のモデルと成り得、 触媒やセンサ等への応用の基礎的な知見となるものと期待できる。本論文では、得られた*Γ*₈の 値から、QH₂は多結晶金電極に平行かつ密に吸着し、単分子膜を形成していると考えられた。 しかし、電極表面は多結晶であるため様々な結晶面が露出しており、結晶面により吸着した QH₂の配列が異なる可能性が考えられる。また、電極表面の凹凸によりQH₂が吸着しやすくな っていることも考えられる。そのため今後、単結晶金電極を用いた吸着特性評価を行う必要が ある。さらに、金表面のヒドロキシ基が電子供与性サイトとして働き、電子受容性を示すQH₂分 子内のイプソ位の炭素およびヒドロキシ基の水素が相互作用するものと考えられた。今後は、 吸着へのpHの影響を詳細に検討することにより、吸着相互作用メカニズムの解明を目指す。

金表面に吸着した QH₂が溶存種の電子移動速度に影響を与えることを新たに見出した。 外圏型電子移動を示す酸化還元活性種に対しては、QH₂の吸着の有無に依存しなかったの に対し、内圏型電子移動を示す酸化還元活性種に対しては、QH₂の吸着により溶存種の電 子移動が遅くなった。吸着した QH₂ が全体の酸化還元反応に影響を与えていることから、 この知見はこれまで未解明な点が多かった Q/QH₂の酸化還元反応のメカニズム解明に向け て、重要な役割を果たすものと期待される。さらに、QH₂の吸着により溶存種の電子移動 速度を制御できる可能性が示されたことから、センサ等への応用も期待される。CV で目 的物質を測定する際、目的物質と反応電位が近い妨害物質が存在すると、電流値から目 的物質の反応量を測定することが困難となる。そこで、QH₂ 吸着電極を用いれば、妨害 物質の電子移動を遅くできるので、目的物質のみを検出できるセンサとなる。例えば、 アスコルビン酸は生物の主な酸化還元反応の多くに関与する NADH を検出する際の妨害 物質として働く。そこで QH₂ 吸着電極を用いてアスコルビン酸の電子移動速度を制御す ることで、NADH を検出できるセンサが構築できるものと期待される。

本研究が分子機能電極の発展に寄与できれば、望外の喜びである。今後この分野の研究が増々発展していくことを切に願う。

参考文献

- R. W. Murray, *Molecular Design of Electrode Surfaces* (Edited by R. W. Murray), p. 1, John Wiley & Sons, New York, (1992).
- 2. 大坂武男, 岡島武義, 新訂版·表面科学の基礎と応用(日本表面科学会編), p. 1403, エ ヌ・ティー・エス, (2004).
- 3. M. Kato, T. Homma, M. Kondo, T. Kuwahara, and M. Shimomura, *J. Technology and Education*, **21**, 1 (2014).
- 4. N. Hisamatsu, T. Iida, T. Yasui, K. Takada, and A. Yuchi, *Sens. Actuators B.*, **203**, 289 (2014).
- 5. K. Takada, N. Tanaka, and T. Tatsuma, J. Electroanal. Chem., 585, 120 (2005).
- C. Berggren, P. Stålhandske, J. Brundell, and G. Johansson, *Electroanal.*, **11**, 156 (1999).
- 7. 近藤精一,石川達雄,安倍郁夫,吸着の科学 第2版,丸善 (2002).
- 8. 竹内節, 吸着の化学, 産業図書 (1995).
- 9. C. H. Giles, D. Smith, and A. Huitson, J. Colloid Interface Sci., 47, 755 (1974).
- 10. 慶伊冨長, 吸着, 共立全書 (1965).
- 11. T. Okajima and T. Ohsaka, *Electrochem.*, **76**, 434 (2008).
- 12. R. F. Lane and A. T. Hubbard, J. Phys. Chem., 77, 1401 (1973).
- 13. B. F. Watkins, J. R. Behling, E. Kariv, and L. L. Miller, *J. Am. Chem. Soc.*, **97**, 3549 (1975).
- N. Oyama and T. Ohsaka, *Molecular Design of Electrode Surfaces* (Edited by R. W. Murray), p. 333, John Wiley & Sons, New York, (1992).
- 15. S. Kuwabata, *Electrochem.*, **67**, 90 (1999).
- 16. K. Uosaki, Y. Sato, and H. Kita, *Langmuir*, 7, 1510 (1991).
- S. Xu, S. J. N. C.-Dupeyrat, J. C. Garno, G.-Y. Liu, G. K. Jennings, T.-H. Yong, and P. E. Laibinis, *J. Chem. Phys.*, **108**, 5002 (1998).
- C. D. Bain, E. B. Troughton, Y.-T. Tao, J. Evall, G. M. Whitesides, and R. G. Nuzzo, *J. Am. Chem. Soc.*, **111**, 321 (1989).
- 19. T. Sawaguchi, *Electrochem.*, 70, 51 (2002).

- 20. T. Kakiuchi and D. Hobara, BUNSEKI KAGAKU, 51, 1089 (2002).
- 21. N. Camillone III, C. E. D. Chidsey, G.-Y. Liu, and G. Scoles, *J. Chem. Phys.*, **98**, 4234 (1993).
- K. Arihara, T. Ariga, N. Takashima, K. Arihara, T. Okajima, F. Kitamura, K. Tokuda, and T. Ohsaka, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **5**, 3758 (2003).
- 23. M. S. El-Deab and T. Ohsaka, *Electrochim. Acta*, **49**, 2189 (2004).
- 24. T. Kakiuchi, H. Usui, D. Hobara, and M. Yamamoto, Langmuir, 18, 5231 (2002).
- 25. D.-F. Yang, C. P. Wilde, and M. Morin, *Langmuir*, **12**, 6570 (1996).
- 26. O. Dannenberger, M. Buck, and M. Grunze, J. Phys. Chem. B, 103, 2202 (1999).
- 27. L. L. Rouhana, M. D. Moussallem, and J. B. Schlenoff, *J. Am. Chem. Soc.*, **133**, 16080 (2011).
- A. Chou, P. K. Eggers, M. N. P.-Row, and J. J. Gooding, *J. Phys. Chem. C*, **113**, 3203 (2009).
- 29. M. Kawasaki, T. Sato, and T. Yoshimoto, Langmuir, 16, 5409 (2000).
- 30. C. A. Alves, E. L. Smith, and M. D. Porter, J. Am. Chem. Soc., 114, 1222 (1992).
- N. Camillone III, C. E. D. Chidsey, P. Eisenberger, P. Fenter, J. Li, K. S. Liang, G.-Y. Liu, and G. Scoles, *J. Chem. Phys.*, 99, 744 (1993).
- G. Mani, D. M. Johnson, D. Marton, M. D. Feldman, D. Patel, A. A. Ayon, and C. M. Agrawal, *Biomater.*, 29, 4561 (2008).
- 33. E. H. Yu and K. Scott, *Energies*, **3**, 23 (2010).
- 34. S. Kuwabata, *Electrochem.*, **67**, 197 (1999).
- 35. M. Ohtani, S. Kuwabata, and H. Yoneyama, Anal. Chem., 69, 1045 (1997).
- 36. E. Y. Katz, J. Electroanal. Chem., 291, 257 (1990).
- 37. M. Kyo, K. U.-Aoki, and H. Koga, Anal. Chem., 77, 7115 (2005).
- 38. I. Willner, E. Y. Katz, and B. Willer, *Electroanal.*, 9, 965 (1997).
- 39. F. Mukae, H. Takemura, and K. Takehara, Bull. Chem. Soc. Jpn., 69, 2461 (1996).
- 40. 岩澤康裕, 化学便覧 基礎編 改訂5版, II-339 (2004).
- 41. T. Kakiuchi, M. lida, and S. Imabayashi, Langmuir, 16, 5397 (2000).
- 42. J. Q. Chambers, *Chemistry of Quinoid Compounds* (Edited by S. Patai), p.737, John Wiley & Sons, New York, (1974).
- 43. M. Quan, D. Sanchez, M. F. Wasylkiw, and D. K. Smith, J. Am. Chem. Soc., 129,

12847 (2007).

- 44. K. Shi and K. K. Shiu, J. Electroanal. Chem., 574, 63 (2004).
- 45. A. Sarapuu, K. Helstein, K. Vaik, D. J. Schiffrin, and K. Tammeveski, *Electrochim. Acta*, **55**, 6376 (2010).
- 46. S. H. DuVall and R. L. McCreery, Anal. Chem., 71, 4594 (1999).
- 47. S. H. DuVall and R. L. McCreery, J. Am. Chem. Soc., 122, 6759 (2000).
- 48. C. Singh and A. Paul, J. Phys. Chem. C, 119, 11382 (2015).
- 49. A. Maleki, D. Nematollahi, J. Clausmeyer, J. Henig, N. Plumeré and W. Schuhmann, *Electroanal.*, **24**, 1932 (2012).
- 50. M. P. Soriaga and A. T. Hubbard, J. Am. Chem. Soc., 104, 2735 (1982).
- 51. M. P. Soriaga and A. T. Hubbard, J. Am. Chem. Soc., 104, 3937 (1982).
- 52. D. Ren and A. T. Hubbard, J. Colloid Interface Sci., 209, 435 (1999).
- G. N. Salaita, L. L.-Davidson, F. Lu, N. Walton, E. Wellner, D. A. Stern, N. Batina, D. G. Frank, C.-H. Lin, C. S. Benton, and A. T. Hubbard, *J. Electroanal. Chem.*, **245**, 253 (1988).
- 54. F. Lu, G. N. Salaita, L. L.-Davidson, D. A. Stern, E. Wellner, D. G. Frank, N. Batina, D. C. Zapien, N. Walton, and A. T. Hubbard, *Langmuir*, 4, 637 (1988).
- 55. A. T. Hubbard, *Heterogeneous Chem. Rev.*, **1**, 3 (1994).
- 56. K. P. Pang, J. B. Benziger, M. P. Soriaga, and A. T. Hubbard, *J. Phys. Chem.*, **88**, 4583 (1984).
- 57. J. E. Soto, Y.-G. Kim, and M. P. Soriaga, *Electrochem. Commun.*, 1, 135 (1999).
- 58. Y.-G. Kim, J. H. Baricuatro, and M. P. Soriaga, Langmuir, 22, 10762 (2006).
- 59. W. Jaenicke and H. Kobayashi, *Electrochim. Acta*, **28**, 245 (1983).
- 60. H. Baltruschat, N. Staud, and J. Heitbaum, J. Electroanal. Chem., 239, 361 (1988).
- 61. S. Trasatti and O. A. Petrii, J. Electroanal. Chem., 327, 353 (1992).
- 62. D. Hobara, *Electrochem.*, **70**, 56 (2002).
- 63. A. Hamelin, J. Electroanal. Chem., 407, 1 (1996).
- 64. M. J. Esplandiú, H. Hagenström, and D. M. Kolb, 17, 828 (2001).
- 65. C. L. Perdriel, A. J. Arvia, and M. Ipohorski, J. Electroanal. Chem., 215, 317 (1986).
- 66. J. D. Tirado, D. Acevedo, R. L. Bretz, and H. D. Abruña, Langmuir, 10, 1971 (1994).
- 67. D. Acevedo, R. L. Bretz, J. D. Tirado, and H. D. Abruña, Langmuir, 10, 1300 (1994).
- J. O'M Bockris, A. K. N. Reddy, and M. Gamboa-Aldeco, *Modern Electrochemistry* Second Edition Fundamentals of Electrodics, p. 919, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, (2000).
- R. I. Masel, *Principles of Adsorption and Reaction on Solid Surfaces*, p. 235, John Wiley & Sons, New York, (1996).
- 70. W. H. Reinmuth, J. Phys. Chem., 65, 473 (1961).
- 71. D. S. Karpovich and G. J. Blanchard, Langmuir, 10, 3315 (1994).
- 72. A. Kudelski and W. Hill, Langmuir, 15, 3162 (1999).
- K. Takada, D. J. Díaz, H. D. Abruña, I. Cuadrado, C. Casado, B. Alonso, M. Morán, and J. Losada, *J. Am. Chem. Soc.*, **119**, 10763 (1997).
- E. Lorenzo, L. Sánchez, F. Pariente, J. Tirado, and H. D. Abruña, *Anal. Chim. Acta*, 309, 79 (1995).
- M. Giesbers, J. M. Kleijn, and M. A. Cohen Stuart, J. Colloid Interface Sci., 248, 88, (2002).
- 76. D. Barten, J. M. Kleijn, J. Duval, H. P. v. Leeuwen, J. Lyklema, and M. A. Cohen Stuart, *Langmuir*, **19**, 1133 (2003).
- 77. P. Chen and R. L. McCreery, Anal. Chem., 68, 3958 (1996).

106

- <u>K. Naito</u>, Y. Maeda, T. Yasui, K. Takada, and A. Yuchi, "Adsorption of Hydroquinone to Polycrystalline Gold Electrode and Its Effect on the Electrochemical Properties", *J. Electrochem. Soc.*, **164**, H670-H674 (2017).
- K. Naito, H. lezaki, T. Yasui, and K. Takada, "Adsorption Kinetics and Thermodynamics of Hydroquinone onto a Polycrystalline Gold Electrode", *J. Electrochem. Soc.*, **165**, H455-H459 (2018).
- K. Naito, K. Iida, and K. Takada, "Adsorption Kinetics and Thermodynamics of 2-Aminoethanethiol onto a Polycrystalline Gold Electrode Determined by Cyclic Voltammetry of Reductive Desorption", *Electrochem.*, in press.

発表状況

- ○内藤 久実、原田 寛之、久松 直樹、高田 主岳、湯地 昭夫、「ポリアクリル酸ゲ ルを利用した複屈曲運動する電気化学アクチュエータ」、「分析中部・ゆめ21」若手 交流会 第13回高山フォーラム、P-62、高山市図書館(岐阜県)、2013年11月
- ○内藤 久実、久松 直樹、原田 寛之、高田 主岳、湯地 昭夫、「キノン-ポリアクリ ル酸ゲルを用いた両面被覆型電気化学アクチュエータ」、電気化学会第81回大会、 2B05、関西大学(大阪府)、2014年3月
- ○内藤 久実、高田 主岳、湯地 昭夫、「カーボンナノチューブ修飾電極におけるキノンの電気化学的応答」、第33回分析化学中部夏期セミナー、P-11、いこいの村 磯 波風(富山県)、2014年9月
- ○内藤 久実、高田 主岳、湯地 昭夫、「カーボンナノチューブ修飾電極のキノンに 対する電気化学的特性評価」、2014年電気化学会秋季大会、1H12、北海道大学高等 教育推進機構(北海道)、2014年9月
- 5. ○<u>内藤 久実</u>、高田 主岳、湯地 昭夫、「カーボンナノチューブ修飾電極のキノンに 対する電気化学的応答評価(2)」、電気化学会第82回大会、1O27、横浜国立大学(神奈 川県)、2015年3月
- O<u>内藤 久実</u>、高田 主岳、湯地 昭夫、「SWCNTs修飾電極のキノンに対する電気化 学的特性評価」、日本分析化学会第64年会、E2002、九州大学(福岡県)、2015年9月
- 7. ○<u>内藤 久実</u>、市川 功二、前田 友梨、安井 孝志、高田 主岳、湯地 昭夫、「アミノ エタンチオール修飾電極のキノンに対する電気化学的応答」、電気化学会第83回大会、 3H03、大阪大学(大阪府)、2016年3月
- ○内藤 久実、市川 功二、前田 友梨、安井 孝志、高田 主岳、湯地 昭夫、「キノン に対するアミノエタンチオール修飾電極の電気化学的特性評価」、第76回分析化学討 論会、E2001、岐阜薬科大学・岐阜大学(岐阜県)、2016年5月
- ○内藤 久実、前田 友梨、安井 孝志、高田 主岳、湯地 昭夫、「ヒドロキノンの金 電極への吸着およびその電気化学的特性への影響」、第35回分析化学中部夏期セミナ ー、P-49、リトリートたくら(福井県)、2016年9月
- ○内藤 久実、前田 友梨、安井 孝志、高田 主岳、湯地 昭夫、「キノンに対するア ミノエタンチオール修飾電極の電気化学的特性評価(2)」、日本分析化学会第65会年会、

E1010、北海道大学工学部(北海道)、2016年9月

- <u>Kumi Naito</u>, Yuri Maeda, Takashi Yasui, Kazutake Takada, and Akio Yuchi, "Specific Response of Quinone Redox at 2-Aminoethanethiol Modified Electrode", Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid-State Sciences 2016, 3588, Hawaii Convention Center (USA), Oct, 2016.
- 12. ○飯田 香苗、内藤 久実、前田 友梨、安井 孝志、高田 主岳、湯地 昭夫、「サイク リックボルタンメトリによる2-アミノエタンチオールの金電極への吸着特性の評価」、 「分析中部・ゆめ21」若手交流会 第16回高山フォーラム、P5、高山市図書館(岐阜 県)、2016年11月
- 13. ○小林 堅亮、<u>内藤 久実</u>、高田 主岳、湯地 昭夫、「アクチュエータの応用を目指した単層カーボンナノチューブ修飾電極の特性評価」、「分析中部・ゆめ21」若手交流会 第16回高山フォーラム、P9、高山市図書館(岐阜県)、2016年11月
- <u>Kumi Naito</u>, Yuri Maeda, Takashi Yasui, Kazutake Takada, and Akio Yuchi, "Specific Electrochemical Response of Hydroquinone at 2-Aminoethanethiol Modified Gold Electrode", The 23rd International SPACC Symposium, P-02, Okayama University of Science (Okayama, Japan), Nov, 2016.
- 15. ○内藤 久実、前田 友梨、安井 孝志、高田 主岳、湯地 昭夫、「ヒドロキノンの多結晶金電極への吸着およびその電気化学特性への影響」、電気化学会第84回大会、 1T08、首都大学東京(東京都)、2017年3月
- 16. ○<u>内藤 久実</u>、「ヒドロキノンの金電極への吸着に対する電気化学的評価」、2017年度 先端錯体工学研究会ミニシンポジウム、名古屋工業大学(愛知県)、2017年4月
- 17. ○小林 堅亮、<u>内藤 久実</u>、高田 主岳、「カーボンナノチューブ被覆電極を用いたポ リアクリル酸ゲルアクチュエータの作製」、第36回分析化学中部夏期セミナー、P-03、 高山市図書館(岐阜県)、2017年8月
- 〇<u>内藤 久実</u>、家崎 展一、前田 友梨、安井 孝志、高田 主岳、「ヒドロキノンの多 結晶金電極への吸着およびその電気化学特性への影響(2)」、2017年電気化学秋季大 会、1111、長崎大学(長崎県)、2017年9月
- 19. ○小林 堅亮、<u>内藤 久実</u>、高田 主岳、「カーボンナノチューブ被覆電極を用いたポ リアクリル酸ゲルアクチュエータの特性」、第48回中部化学関係学協会支部連合秋 季大会、2K07、岐阜大学(岐阜県)、2017年11月

- 20. ○家崎 展一、内藤 久実、高田 主岳、「ヒドロキノンの多結晶金電極への速度論的 吸着特性評価」、「分析中部・ゆめ21」若手交流会 第17回高山フォーラム、P-11、 高山市図書館(岐阜県)、2017年11月
- 21. ○山本 千賀、飯田 香苗、内藤 久実、高田 主岳、「還元脱離法による2-アミノエタ ンチオールの金への吸着特性評価」、「分析中部・ゆめ21」若手交流会 第17回高山 フォーラム、P-18、高山市図書館(岐阜県)、2017年11月
- 22. ○飯田 香苗、山本 千賀、内藤 久実、安井 孝志、高田 主岳、「2-アミノエタンチ オールの多結晶金上への吸着特性」、電気化学会第85回大会、1P16、東京理科大学 (東京都)、2018年3月
- 23. ○小林 堅亮、<u>内藤 久実</u>、高田 主岳、「カーボンナノチューブを導入したポリアク リル酸ゲルアクチュエータの動作特性」、電気化学会第85回大会、1P20、東京理科 大学(東京都)、2018年3月
- 24. ○<u>内藤 久実</u>、家崎 展一、安井 孝志、高田 主岳、「ヒドロキノンの多結晶金電極
 への吸着特性評価」、電気化学会第85回大会、1P21、東京理科大学(東京都)、2018
 年3月
- 25. ○内藤 久実、丸本 健志、前田 友梨、安井 孝志、高田 主岳、「ヒドロキノンの多結晶金電極への吸着およびその電気化学特性への影響(3)」、2018年電気化学秋季大会、1N03、金沢大学(石川県)、2018年9月
- 26. ○小林 堅亮、<u>内藤 久実</u>、高田 主岳、「カーボンナノチューブを導入したポリアク リル酸ゲルアクチュエータの動作特性(2)」、2018年電気化学秋季大会、1N05、金沢 大学(石川県)、2018年9月
- 27. ○飯田 香苗、稲吉 凛香、内藤 久実、安井 孝志、高田 主岳、「2-アミノエタンチオールの金電極への吸着特性評価」、2018年電気化学秋季大会、1N11、金沢大学(石川県)、2018年9月

受賞

- 1. 「分析中部・ゆめ21」若手交流会 第13回高山フォーラム 最優秀賞
- 2. 第33回分析化学中部夏期セミナー

優秀ポスター発表賞

3. 第35回分析化学中部夏期セミナー

優秀ポスター発表賞

謝辞

本研究を行うにあたり、研究全般および研究室生活にわたって貴重なご助言とご指導を与え てくださいました、名古屋工業大学大学院 工学研究科 高田主岳教授に心から感謝致しま す。

ご多忙の中、学位審査をして頂きました、名古屋工業大学大学院 工学研究科 大谷肇教 授、北川慎也准教授、信州大学 巽広輔准教授には有益なご助言とご指導を頂きました。ここ に感謝の意を捧げます。

本研究を行うにあたり、様々なご助力、ご助言を頂きました名古屋工業大学大学院 工学研 究科 安井孝志准教授、高田研究室および大型設備基盤センターの皆様に感謝致します。特 に、私の研究を共に支えてくださった、高田研究室の飯田香苗さん、家崎展一君、丸本健志君 には心より感謝申し上げます。

最後に博士後期課程への進学に理解を示し、支えてくださった両親に深く感謝し、厚くお礼 申し上げます。

これまでにお世話になった方々全てに心から感謝の気持ちを捧げ、謝辞と致します。

2019年1月

内藤 久実